

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

295-17-115
SAH
#5
2-19-02

JCS66 U.S. PRO
09/870241
05/30/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月30日

出願番号

Application Number:

特願2000-159772

出願人

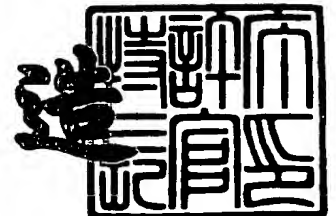
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年 4月13日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3030178

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0079049

【提出日】 平成12年 5月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01F 1/053

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 新井 聖

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 加藤 洋

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

 【代表者】 安川 英昭

【代理人】

 【識別番号】 100093388

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

 【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

 【識別番号】 100095728

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

 【識別番号】 100107261

 【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 冷却ロール、薄帯状磁石材料、磁石粉末およびボンド磁石

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 磁石材料の溶湯をその周面に衝突させ、冷却固化して、薄帯状磁石材料を製造するための冷却ロールであって、

冷却ロールの周面上に、前記薄帯状磁石材料の冷却ロールとの接触面において発生するディンプルを分割するディンプル矯正手段を設けたことを特徴とする冷却ロール。

【請求項 2】 前記周面を形成する表面層を有し、前記表面層に前記ディンプル矯正手段を設けたものである請求項 1 に記載の冷却ロール。

【請求項 3】 前記表面層は、セラミックスで構成される請求項 2 に記載の冷却ロール。

【請求項 4】 前記表面層の平均厚さは、 $0.5 \sim 50 \mu\text{m}$ である請求項 2 または 3 に記載の冷却ロール。

【請求項 5】 前記表面層は、その表面に機械加工を行わないで形成されたものである請求項 2 ないし 4 のいずれかに記載の冷却ロール。

【請求項 6】 前記ディンプル矯正手段は、少なくとも 1 本の凸条または溝である請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の冷却ロール。

【請求項 7】 前記凸条の平均幅は、 $0.5 \sim 95 \mu\text{m}$ である請求項 6 に記載の冷却ロール。

【請求項 8】 前記溝の平均幅は、 $0.5 \sim 90 \mu\text{m}$ である請求項 6 または 7 に記載の冷却ロール。

【請求項 9】 前記凸条の平均高さまたは前記溝の平均深さは、 $0.5 \sim 20 \mu\text{m}$ である請求項 6 ないし 8 のいずれかに記載の冷却ロール。

【請求項 10】 前記凸条または前記溝は、前記冷却ロールの回転軸を中心とする螺旋状に形成されたものである請求項 6 ないし 9 のいずれかに記載の冷却ロール。

【請求項 11】 前記凸条または前記溝が並設されており、その平均ピッチは、 $0.5 \sim 100 \mu\text{m}$ である請求項 6 ないし 10 のいずれかに記載の冷却ロー

ル。

【請求項 1 2】 前記周面上における前記凸条または前記溝の占める投影面積の割合が 1 0 % 以上である請求項 6 ないし 1 1 のいずれかに記載の冷却ロール。

【請求項 1 3】 磁石材料の溶湯を冷却ロールの周面に衝突させ、冷却固化して得られた薄帯状磁石材料であって、

前記冷却ロールとの接触面に溝または凸条が形成されており、該溝または該凸条によりディンプルが分割されていることを特徴とする薄帯状磁石材料。

【請求項 1 4】 請求項 1 ないし 1 2 のいずれかに記載の冷却ロールを用いて製造されたことを特徴とする薄帯状磁石材料。

【請求項 1 5】 前記冷却ロールとの接触面において、凝固時に形成された $2000\mu\text{m}^2$ 以上の巨大ディンプルの占める面積の割合が、1 0 % 以下である請求項 1 3 または 1 4 に記載の薄帯状磁石材料。

【請求項 1 6】 前記冷却ロールとの接触面は、前記冷却ロールの表面形状の少なくとも一部が転写されたものである請求項 1 3 ないし 1 5 のいずれかに記載の薄帯状磁石材料。

【請求項 1 7】 前記冷却ロールとの接触面に溝または凸条が形成されており、該溝または該凸条によりディンプルが分割されている請求項 1 4 ないし 1 6 のいずれかに記載の薄帯状磁石材料。

【請求項 1 8】 平均厚さが $8\sim 50\mu\text{m}$ である請求項 1 3 ないし 1 7 のいずれかに記載の薄帯状磁石材料。

【請求項 1 9】 請求項 1 3 ないし 1 8 のいずれかに記載の薄帯状磁石材料を粉砕して得られたことを特徴とする磁石粉末。

【請求項 2 0】 磁石粉末は、その製造過程または製造後少なくとも 1 回熱処理が施されたものである請求項 1 9 に記載の磁石粉末。

【請求項 2 1】 平均粒径が $1\sim 300\mu\text{m}$ である請求項 1 9 または 2 0 に記載の磁石粉末。

【請求項 2 2】 磁石粉末は、ソフト磁性相とハード磁性相とを有する複合組織で構成されるものである請求項 1 9 ないし 2 1 のいずれかに記載の磁石粉末

【請求項 2 3】 前記ハード磁性相および前記ソフト磁性相の平均結晶粒径は、いずれも $1 \sim 100 \text{ nm}$ である請求項 2 2 に記載の磁石粉末。

【請求項 2 4】 請求項 1 9 ないし 2 3 のいずれかに記載の磁石粉末を結合樹脂で結合してなることを特徴とするボンド磁石。

【請求項 2 5】 室温での固有保磁力 H_{cJ} が $320 \sim 1200 \text{ kA/m}$ である請求項 2 4 に記載のボンド磁石。

【請求項 2 6】 最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\max}$ が 40 kJ/m^3 以上である請求項 2 4 または 2 5 に記載のボンド磁石。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、冷却ロール、薄帯状磁石材料、磁石粉末およびボンド磁石に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

磁石材料として、希土類元素を含む合金で構成される希土類磁石材料は、高い磁気特性を有するため、モータ等に用いられた場合に、高性能を発揮する。

【0003】

このような磁石材料は、例えば急冷薄帯製造装置を用いた急冷法により製造される。以下、この製造方法を説明する。

【0004】

図 2 3 は、従来の磁石材料を単ロール法により製造する装置（急冷薄帯製造装置）における溶湯の冷却ロールへの衝突部位付近の状態を示す断面側面図である。

【0005】

同図に示すように、所定の合金組成の磁石材料（以下「合金」と言う）を溶融し、その溶湯 6 0 を図示しないノズルから射出し、ノズルに対して図 2 3 中矢印 A 方向に回転している冷却ロール 5 0 0 の周面 5 3 0 に衝突させ、この周面 5 3

0 と接触させることにより合金を急冷、凝固し、薄帯状（リボン状）の合金を連続的に形成する。この薄帯状の合金は、急冷薄帯と呼ばれ、速い冷却速度で凝固された結果、そのミクロ組織は、非晶質相や微細結晶相からなる組織となっており、そのまま、または熱処理を施すことにより、優れた磁気特性を発揮する。なお、図 2 3 中、溶湯 6 0 の凝固界面 7 1 0 を点線で示す。

【 0 0 0 6 】

ここで、希土類元素は、酸化され易く、酸化されると磁気特性が低下するため、前記急冷薄帯 8 0 の製造は、主として不活性ガス中で行われていた。

【 0 0 0 7 】

そのため、周面 5 3 0 と、溶湯 6 0 のパドル（湯溜り） 7 0 との間にガスが侵入し、急冷薄帯 8 0 のロール面（冷却ロール 5 0 0 の周面 5 3 0 と接触する面） 8 1 0 にディンプル（凹部） 9 を生じることがあった。この傾向は、冷却ロール 5 0 0 の周速度が大きくなるほど顕著となり、生じるディンプルの面積も大きくなる。

【 0 0 0 8 】

このディンプル 9（特に、巨大ディンプル）が生じると、ディンプル部分においては、ガスの介在により冷却ロール 5 0 0 の周面 5 3 0 との接触不良が生じ、冷却速度が低下して、急速な凝固が妨げられる。そのため、ディンプル 9 が生じた部位では、合金の結晶粒径が粗大化し、磁気特性が低下する。

【 0 0 0 9 】

このような低磁気特性の部分を含む急冷薄帯を粉碎して得られる磁石粉末は、磁気特性のバラツキが大きくなる。したがって、このような磁石粉末を用いて製造されたボンド磁石は、低い磁気特性しか得られず、また、耐食性も低下する。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、磁気特性が優れ、信頼性に優れた磁石を提供することができる冷却ロール、薄帯状磁石材料、磁石粉末およびボンド磁石を提供することにある。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

このような目的は、下記（１）～（２６）の本発明により達成される。

【００１２】

（１） 磁石材料の溶湯をその周面に衝突させ、冷却固化して、薄帯状磁石材料を製造するための冷却ロールであって、

冷却ロールの周面上に、前記薄帯状磁石材料の冷却ロールとの接触面において発生するディンプルを分割するディンプル矯正手段を設けたことを特徴とする冷却ロール。

【００１３】

（２） 前記周面を形成する表面層を有し、前記表面層に前記ディンプル矯正手段を設けたものである上記（１）に記載の冷却ロール。

【００１４】

（３） 前記表面層は、セラミックスで構成される上記（２）に記載の冷却ロール。

【００１５】

（４） 前記表面層の平均厚さは、 $0.5 \sim 50 \mu\text{m}$ である上記（２）または（３）に記載の冷却ロール。

【００１６】

（５） 前記表面層は、その表面に機械加工を行わないで形成されたものである上記（２）ないし（４）のいずれかに記載の冷却ロール。

【００１７】

（６） 前記ディンプル矯正手段は、少なくとも１本の凸条または溝である上記（１）ないし（５）のいずれかに記載の冷却ロール。

【００１８】

（７） 前記凸条の平均幅は、 $0.5 \sim 95 \mu\text{m}$ である上記（６）に記載の冷却ロール。

【００１９】

（８） 前記溝の平均幅は、 $0.5 \sim 90 \mu\text{m}$ である上記（６）または（７）に記載の冷却ロール。

【 0 0 2 0 】

(9) 前記凸条の平均高さまたは前記溝の平均深さは、 $0.5 \sim 20 \mu\text{m}$ である上記 (6) ないし (8) のいずれかに記載の冷却ロール。

【 0 0 2 1 】

(1 0) 前記凸条または前記溝は、前記冷却ロールの回転軸を中心とする螺旋状に形成されたものである上記 (6) ないし (9) のいずれかに記載の冷却ロール。

【 0 0 2 2 】

(1 1) 前記凸条または前記溝が並設されており、その平均ピッチは、 $0.5 \sim 100 \mu\text{m}$ である上記 (6) ないし (1 0) のいずれかに記載の冷却ロール。

【 0 0 2 3 】

(1 2) 前記周面上における前記凸条または前記溝の占める投影面積の割合が 1 0 % 以上である上記 (6) ないし (1 1) のいずれかに記載の冷却ロール。

【 0 0 2 4 】

(1 3) 磁石材料の溶湯を冷却ロールの周面に衝突させ、冷却固化して得られた薄帯状磁石材料であって、

前記冷却ロールとの接触面に溝または凸条が形成されており、該溝または該凸条によりディンプルが分割されていることを特徴とする薄帯状磁石材料。

【 0 0 2 5 】

(1 4) 上記 (1) ないし (1 2) のいずれかに記載の冷却ロールを用いて製造されたことを特徴とする薄帯状磁石材料。

【 0 0 2 6 】

(1 5) 前記冷却ロールとの接触面において、凝固時に形成された $2000 \mu\text{m}^2$ 以上の巨大ディンプルの占める面積の割合が、1 0 % 以下である上記 (1 3) または (1 4) に記載の薄帯状磁石材料。

【 0 0 2 7 】

(1 6) 前記冷却ロールとの接触面は、前記冷却ロールの表面形状の少なくとも一部が転写されたものである上記 (1 3) ないし (1 5) のいずれかに記載

の薄帯状磁石材料。

【 0 0 2 8 】

(1 7) 前記冷却ロールとの接触面に溝または凸条が形成されており、該溝または該凸条によりディンプルが分割されている上記 (1 4) ないし (1 6) のいずれかに記載の薄帯状磁石材料。

【 0 0 2 9 】

(1 8) 平均厚さが $8 \sim 50 \mu\text{m}$ である上記 (1 3) ないし (1 7) のいずれかに記載の薄帯状磁石材料。

【 0 0 3 0 】

(1 9) 上記 (1 3) ないし (1 8) のいずれかに記載の薄帯状磁石材料を粉砕して得られたことを特徴とする磁石粉末。

【 0 0 3 1 】

(2 0) 磁石粉末は、その製造過程または製造後少なくとも 1 回熱処理が施されたものである上記 (1 9) に記載の磁石粉末。

【 0 0 3 2 】

(2 1) 平均粒径が $1 \sim 300 \mu\text{m}$ である上記 (1 9) または (2 0) に記載の磁石粉末。

【 0 0 3 3 】

(2 2) 磁石粉末は、ソフト磁性相とハード磁性相とを有する複合組織で構成されるものである上記 (1 9) ないし (2 1) のいずれかに記載の磁石粉末。

【 0 0 3 4 】

(2 3) 前記ハード磁性相および前記ソフト磁性相の平均結晶粒径は、いずれも $1 \sim 100 \text{nm}$ である上記 (2 2) に記載の磁石粉末。

【 0 0 3 5 】

(2 4) 上記 (1 9) ないし (2 3) のいずれかに記載の磁石粉末を結合樹脂で結合してなることを特徴とするボンド磁石。

【 0 0 3 6 】

(2 5) 室温での固有保磁力 H_{cJ} が $320 \sim 1200 \text{kA/m}$ である上記 (2 4) に記載のボンド磁石。

【 0 0 3 7 】

(2 6) 最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\max}$ が 40 kJ/m^3 以上である上記 (2 4) または (2 5) に記載のボンド磁石。

【 0 0 3 8 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の冷却ロール、薄帯状磁石材料、磁石粉末およびボンド磁石の実施の形態について、詳細に説明する。

【 0 0 3 9 】

〔急冷薄帯製造装置の構成〕

図 1 は、本発明の冷却ロールの第 1 実施形態と、その冷却ロールを用い、単ロール法により薄帯状磁石材料を製造する装置（急冷薄帯製造装置）の構成例とを示す斜視図、図 2 は、図 1 に示す冷却ロールの正面図、図 3 は、図 1 に示す冷却ロールの拡大断面図である。

【 0 0 4 0 】

これらの図に示すように、急冷薄帯製造装置 1 は、磁石材料を収納し得る筒体 2 と、該筒体 2 に対し図中矢印 A 方向に回転する冷却ロール 5 とを備えている。筒体 2 の下端には、磁石材料の溶湯 6 を射出するノズル（オリフィス） 3 が形成されている。

【 0 0 4 1 】

筒体 2 の構成材料としては、例えば、石英、アルミナ、マグネシア等の耐熱性セラミックス等が挙げられる。

【 0 0 4 2 】

ノズル 3 の開口形状としては、例えば、円形、楕円形、スリット状等が挙げられる。

【 0 0 4 3 】

また、筒体 2 のノズル 3 近傍の外周には、加熱用のコイル 4 が配置され、このコイル 4 に例えば高周波を印加することにより、筒体 2 内を加熱（誘導加熱）し、筒体 2 内の磁石材料を溶融状態にする。

【 0 0 4 4 】

なお、加熱手段は、このようなコイル4に限らず、例えば、カーボンヒータを用いることもできる。

【0045】

冷却ロール5は、基部51と、冷却ロール5の周面53を形成する表面層52とで構成されている。

【0046】

表面層52は、基部51と同じ材質で一体構成されていてもよいが、基部51の構成材料より熱伝導率の小さい材料で構成されているのが好ましい。

【0047】

基部51の構成材料は、特に限定されないが、表面層52の熱をより速く放散できるように、例えば銅または銅系合金のような熱伝導率の高い金属材料で構成されているのが好ましい。

【0048】

また、表面層52の構成材料としては、例えば、Cr、Ni、Pd、W等、またはこれらを含む合金等の金属薄層や金属酸化物層、セラミックス等が挙げられる。その中でも、特に、急冷薄帯（薄帯状磁石材料）8のロール面（冷却ロール5と接触する側の面）81とフリー面（ロール面81の反対側の面）82との冷却速度の差をより小さくできるという点で、セラミックスであるのが好ましい。

【0049】

セラミックスとしては、例えば、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 、 Ti_2O_3 、 ZrO_2 、 Y_2O_3 、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム等の酸化物系セラミックス、 AlN 、 Si_3N_4 、 TiN 、 BN 等の窒化物系セラミックス、グラファイト、 SiC 、 ZrC 、 Al_4C_3 、 CaC_2 、 WC 等の炭化物系のセラミックス、あるいは、これらのうちの2以上を任意に組合せた複合セラミックスが挙げられる。

【0050】

また、表面層52は、図示のような単層のみならず、例えば組成の異なる複数の層の積層体であってもよい。この場合、隣接する層同士は、密着性の高いものが好ましく、その例としては、隣接する層同士に同一の元素が含まれているもの

が挙げられる。

【 0 0 5 1 】

また、表面層 5 2 が単層で構成されている場合でも、その組成は、厚さ方向に均一なものに限らず、例えば、含有成分が厚さ方向に順次変化するもの（傾斜材料）であってもよい。

【 0 0 5 2 】

表面層 5 2 の平均厚さ（前記積層体の場合はその合計厚さ）は、特に限定されないが、0.5～50 μm であることが好ましく、1～20 μm であることがより好ましい。

【 0 0 5 3 】

表面層 5 2 の平均厚さが下限値未満であると、次のような問題が生じる場合がある。すなわち、表面層 5 2 の材質によっては、冷却能が大きすぎて、厚さがかなり大きい急冷薄帯 8 でもロール面 8 1 では冷却速度が大きく、非晶質になり易くなる。一方、フリー面 8 2 では急冷薄帯 8 の熱伝導率が比較的小さいので急冷薄帯 8 の厚さが大きいほど冷却速度が小さくなり、その結果、結晶粒径の粗大化が起こり易くなる。すなわち、フリー面 8 2 では粗大粒、ロール面 8 1 では非晶質といった急冷薄帯となり易くなり、満足な磁気特性が得られない場合がある。また、フリー面 8 2 での結晶粒径を小さくするために、例えば、冷却ロール 5 の周速度を大きくして、急冷薄帯 8 の厚さを小さくしたとしても、ロール面 8 1 での非晶質がよりランダムなものとなり、急冷薄帯 8 の作成後に、熱処理を施したとしても、十分な磁気特性が得られない場合がある。

【 0 0 5 4 】

また、表面層 5 2 の平均厚さが上限値を超えると、急冷速度が遅く、結晶粒径の粗大化が起こり、結果として磁気特性が低下する場合がある。

【 0 0 5 5 】

表面層 5 2 の形成方法は、特に限定されないが、熱 CVD、プラズマ CVD、レーザー CVD などの化学蒸着法（CVD）または真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティングなどの物理蒸着法（PVD）が好ましい。これらの方法を用いた場合、比較的容易に、表面層の厚さを均一にすることができ、表面

層 5 2 の形成後、その表面に機械加工を行わなくてよい。なお、表面層 5 2 は、その他、電解メッキ、浸漬メッキ、無電解メッキ、溶射等の方法で形成されてもよい。

【 0 0 5 6 】

[ディンプル矯正手段]

後述するように、急冷薄帯 8 は、冷却ロール 5 の周面 5 3 に磁石材料の溶湯 6 を衝突させ、急冷することにより製造される。このとき、周面 5 3 と、溶湯 6 のパドル（湯溜り） 7 との間にガスが侵入することにより、ロール面 8 1 においてディンプルが発生する場合がある。図 4 に示すように、ガスが侵入した部位は、ガスが溜まった状態で冷却されるので、得られる急冷薄帯 8 のロール面 8 1 には、ディンプル 9 が発生することとなる（図 6 参照）。また、ガスが侵入した部位では、パドル 7 の他の部位に比べて、冷却速度が小さくなり、結晶粒径の粗大化が起こる。その結果、急冷薄帯 8 の各部位における結晶粒径、磁気特性のバラツキが大きくなる。このような傾向は、ディンプル 9 の 1 個あたりの面積、ディンプル 9 の総面積が大きくなるほど顕著となる。

【 0 0 5 7 】

これに対し、本発明の冷却ロール 5 の周面 5 3 には、急冷薄帯 8 のロール面 8 1 において発生するディンプル 9 を分割するディンプル矯正手段が設けられている。

【 0 0 5 8 】

これにより、図 5、図 7 に示すように、ディンプル 9 は、溝 8 4 によって分割される。また、後述するガス抜き効果により、周面 5 3 とパドル 7 との間に侵入したガスの少なくとも一部が排出されることとなり、周面 5 3 とパドル 7 との間に残存するガス量は少なくなる。これらの理由から、得られる急冷薄帯 8 のロール面 8 1 に形成されるディンプル 9 の 1 個あたりの面積は小さくなり、ディンプル 9 の総面積も減少する（図 7 参照）。そのため、パドル 7 の各部位における冷却速度のバラツキが小さくなり、結果として、結晶粒径のバラツキが小さく、磁気特性に優れた急冷薄帯 8 が得られる。

【 0 0 5 9 】

図示の構成では、ディンプル矯正手段として、冷却ロール5の周面53上に、溝54が冷却ロールの回転方向に対し、ほぼ平行に形成されている。（このとき、隣接する溝54、溝54間は、凸条55となっている。また、逆に、隣接する凸条55、凸条55間は、溝54となっているものとみなすこともできる。このように、溝と凸条とは、相対する関係にあるので、以下、特に断りのない限り、ディンプル矯正手段として、溝について代表的に説明する。）

【0060】

溝54が周面53上に設けられていることにより、周面53とパドル7との間に侵入したガスは、溝54内に入り込んだ後、さらに溝54に沿って移動することが可能となる。そのため、周面53とパドル7との間に侵入したガスは、冷却ロール5の回転に伴い、溝54を介して外部に排出される。このような効果（ガス抜き効果）により、ガスが侵入した部位における周面53とパドル7との接触が起こり易くなる。このようにして周面53とパドル7との接触が起こると、図7に示すように、ディンプル9は分割され、ディンプルの1個あたりの面積は小さくなる。また、周面53とパドル7との間に残存するガス量が少なくなるため、形成されるディンプル9の総面積も小さくなる。したがって、パドル7の各部位における冷却速度のバラツキは、小さくなり、結果として、結晶粒径のバラツキが小さく、磁気特性に優れた急冷薄帯8が得られる。

【0061】

図示の構成では、溝54および凸条55は、それぞれ複数本形成されているが、少なくとも1本形成されていればよい。

【0062】

溝54の幅（周面53へ開口している部分での幅） L_1 の平均値は、 $0.5 \sim 90 \mu\text{m}$ であるのが好ましく、 $1 \sim 50 \mu\text{m}$ であるのがより好ましい。溝54の幅 L_1 の平均値が下限値未満であると、周面53とパドル7との間に侵入したガスを排出するガス抜き効果が低下し、ディンプル矯正手段としての効果が十分に発揮されない場合がある。一方、溝54の幅 L_1 の平均値が上限値を超えると、溝54で面積の大きいディンプルが発生し、結晶粒が粗大化する場合がある。

【0063】

凸条 5 5 の幅（最大幅） L_2 の平均値は、 $0.5 \sim 95 \mu m$ であるのが好ましく、 $1 \sim 50 \mu m$ であるのがより好ましい。凸条 5 5 の幅 L_2 の平均値が下限値未満であると、ディンプルの矯正手段として、凸条が十分に機能しなくなり、結果として、大面積のディンプルが形成される場合がある。一方、凸条 5 5 の幅 L_2 の平均値が上限値を超えると、凸条の表面積が大きくなり、凸条とパドルとの間にディンプルが形成される場合がある。

【 0 0 6 4 】

溝 5 4 の最大深さ（または凸条 5 5 の最大高さ） L_3 の平均値は、 $0.5 \sim 20 \mu m$ であるのが好ましく、 $1 \sim 10 \mu m$ であるのがより好ましい。溝 5 4 の深さ L_3 の平均値が下限値未満であると、周面 5 3 とパドル 7 との間に侵入したガスを排出するガス抜き効果が低下し、ディンプル矯正手段としての効果が十分に発揮されない場合がある。一方、溝 5 4 の深さ L_3 の平均値が上限値を超えると、溝 5 4 を流れるガス流の流速が増大するとともに、渦を伴う乱流となり易くなり、ディンプル矯正手段としての効果が十分に発揮されない場合がある。

【 0 0 6 5 】

並設されている溝 5 4（または並設されている凸条 5 5）のピッチ L_4 は、ロール面 8 1 上に形成されるディンプル 9 の 1 個あたりの大きさや、ディンプル 9 の総面積を規定する重要な要件である。並設されている溝 5 4（または並設されている凸条 5 5）のピッチ L_4 の平均値は、 $0.5 \sim 100 \mu m$ であるのが好ましく、 $3 \sim 50 \mu m$ であるのがより好ましい。溝 5 4 のピッチ L_4 の平均値がこのような範囲の値であると、溝 5 4（または凸条 5 5）がディンプル矯正手段として十分に機能し、かつパドル 7 との接触部分－非接触部分の間隔が十分小さくなる。その結果、周面 5 3 に接触している部分と接触していない部分との冷却速度の差は、十分小さくなり、得られる急冷薄帯 8 の結晶粒径、磁気特性のパラツキは小さくなる。

【 0 0 6 6 】

周面 5 3 上における溝 5 4（または凸条 5 5）の占める投影面積（周面に投影したときの面積）の割合は、 10% 以上であるのが好ましく、 $30 \sim 99.5\%$ であるのがより好ましい。周面 5 3 上における溝 5 4（または凸条 5 5）の占め

る投影面積の割合が10%未満であると、周面53とパドル7との間に巻き込まれるガス量に対して、ガス抜きのための流路が十分に確保されず、周面53とパドル7との間にガスが残存し、その結果、巨大ディンプルを形成し易くなる。

【0067】

溝54および凸条55は、いかなる方法で形成されたものであってもよい。

溝54は、例えば、冷却ロール5の周面53に対し、切削、転写（圧転）、研削、プラスト処理等の各種機械加工、レーザー加工、放電加工、化学エッチング等を施すことにより形成することができる。その中でも、溝54の幅、深さ、並設された溝54のピッチ等の精度を高くすることが比較的容易である点で、機械加工、特に、切削であるのが好ましい。

【0068】

また、凸条55は、例えば、周面53に前述した溝54の形成方法による加工を施した結果、（周面53上に残存する部分として）形成されたものであってもよい。

【0069】

基部51の外周面上に表面層52が設けられる場合（表面層52が基部51と一体形成されていない場合）、溝54または凸条55は、表面層に直接、前述した方法により形成されたものであっても、そうでなくてもよい。すなわち、図8に示すように、表面層52を設けた後、その表面層に前述した方法により溝54または凸条を形成してもよいが、図9に示すように、基部51の外周面上に、前述した方法により溝または凸条を形成した後、表面層52を形成してもよい。この場合、表面層52の厚さを基部51に形成された溝の深さまたは凸条の高さに比べて小さくすることにより、結果として、表面層52の表面に機械加工を施すことなく、周面53上にディンプル矯正手段である溝54または凸条55が形成される。この場合、表面層52の表面に機械加工等が施されないため、その後、研磨等が施されなくても周面53の表面粗さRaを比較的小さくすることができる。

【0070】

なお、図3、図5（後述する図14、図16、図18、図20、図21も同様

）では、基部と表面層との境界は、省略して示した。

【 0 0 7 1 】

〔磁石材料の合金組成〕

本発明における薄帯状磁石材料や磁石粉末としては、優れた磁気特性を有するものが好ましく、このようなものとしては、R（ただし、Rは、Yを含む希土類元素のうちの少なくとも1種）を含む合金、特にR（ただし、Rは、Yを含む希土類元素のうちの少なくとも1種）とTM（ただし、TMは、遷移金属のうちの少なくとも1種）とB（ボロン）とを含む合金が挙げられ、次の〔1〕～〔5〕の組成のものが好ましい。

【 0 0 7 2 】

〔1〕 Smを主とする希土類元素と、Coを主とする遷移金属とを基本成分とするもの（以下、Sm-Co系合金と言う）。

【 0 0 7 3 】

〔2〕 R（ただし、Rは、Yを含む希土類元素のうちの少なくとも1種）と、Feを主とする遷移金属（TM）と、Bとを基本成分とするもの（以下、R-TM-B系合金と言う）。

【 0 0 7 4 】

〔3〕 Smを主とする希土類元素と、Feを主とする遷移金属と、Nを主とする格子間元素とを基本成分とするもの（以下、Sm-Fe-N系合金と言う）。

【 0 0 7 5 】

〔4〕 R（ただし、Rは、Yを含む希土類元素のうち少なくとも1種）とFe等の遷移金属とを基本成分とし、ソフト磁性相とハード磁性相とが相隣接して（粒界相を介して隣接する場合も含む）存在する複合組織（特に、ナノコンポジット組織と呼ばれるものがある）を有するもの。

【 0 0 7 6 】

〔5〕 前記〔1〕～〔4〕の組成のものうち、少なくとも2種を混合したもの。この場合、混合する各磁石粉末の利点を併有することができ、より優れた磁気特性を容易に得ることができる。

【0077】

Sm-Co系合金の代表的なものとしては、 SmCo_5 、 $\text{Sm}_2\text{TM}_{17}$ （ただしTMは、遷移金属）が挙げられる。

【0078】

R-Fe-B系合金の代表的なものとしては、Nd-Fe-B系合金、Pr-Fe-B系合金、Nd-Pr-Fe-B系合金、Nd-Dy-Fe-B系合金、Ce-Nd-Fe-B系合金、Ce-Pr-Nd-Fe-B系合金、これらにおけるFeの一部をCo、Ni等の他の遷移金属で置換したもの等が挙げられる。

【0079】

Sm-Fe-N系合金の代表的なものとしては、 $\text{Sm}_2\text{Fe}_{17}$ 合金を窒化して作製した $\text{Sm}_2\text{Fe}_{17}\text{N}_3$ 、 TbCu_7 型相を主相とするSm-Zr-Fe-Co-N系合金が挙げられる。ただし、これらSm-Fe-N系合金の場合、Nは、急冷薄帯を作製した後、得られた急冷薄帯に適切な熱処理を施し、窒化することにより格子間原子として導入されるのが一般的である。

【0080】

前記希土類元素としては、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、ミッシュメタルが挙げられ、これらを1種または2種以上含むことができる。また、前記遷移金属としては、Fe、Co、Ni等が挙げられ、これらを1種または2種以上含むことができる。

【0081】

また、保磁力、最大磁気エネルギー積等の磁気特性を向上させるため、あるいは、耐熱性、耐食性を向上させるために、磁石材料中には、必要に応じ、Al、Cu、Ga、Si、Ti、V、Ta、Zr、Nb、Mo、Hf、Ag、Zn、P、Ge、Cr、W等を含むこともできる。

【0082】

前記複合組織（ナノコンポジット組織）は、ソフト磁性相10とハード磁性相11とが、例えば、図10、図11または図12に示すようなパターン（モデル）で存在しており、各相の厚さや粒径がナノメートルレベルで存在している。そ

して、ソフト磁性相 1 0 とハード磁性相 1 1 とが相隣接し（粒界相を介して隣接する場合も含む）、磁氣的な交換相互作用を生じる。

【 0 0 8 3 】

ソフト磁性相の磁化は、外部磁界の作用により容易にその向きを変えるので、ハード磁性相に混在すると、系全体の磁化曲線は $B-H$ 図（ $J-H$ 図）の第二象現で段のある「へび型曲線」となる。しかし、ソフト磁性相のサイズが数 1 0 n m 以下と十分小さい場合には、ソフト磁性体の磁化が周囲のハード磁性体の磁化との結合によって十分強く拘束され、系全体がハード磁性体として振舞うようになる。

【 0 0 8 4 】

このような複合組織（ナノコンポジット組織）を持つ磁石は、主に、以下に挙げる特徴 1）～5）を有している。

【 0 0 8 5 】

- 1) $B-H$ 図（ $J-H$ 図）の第二象現で、磁化が可逆的にスプリングバックする（この意味で「スプリング磁石」とも言う）。
- 2) 着磁性が良く、比較的低い磁場で着磁できる。
- 3) 磁気特性の温度依存性がハード磁性相単独の場合に比べて小さい。
- 4) 磁気特性の経時変化が小さい。
- 5) 微粉碎しても磁気特性が劣化しない。

【 0 0 8 6 】

このように、複合組織で構成される磁石は、優れた磁気特性を有する。したがって、磁石粉末は、このような複合組織を有するものであるのが特に好ましい。

【 0 0 8 7 】

なお、図 1 0 ～図 1 2 に示すパターンは、一例であって、これらに限られるものではない。

【 0 0 8 8 】

〔薄帯状磁石材料の製造〕

次に、前述した冷却ロール 5 を用いた薄帯状磁石材料の製造について説明する。

【 0 0 8 9 】

薄帯状磁石材料は、磁石材料の溶湯を冷却ロールの周面に衝突させ、冷却固化することにより製造される。以下、その一例について説明する。

【 0 0 9 0 】

図 1 に示すように、急冷薄帯製造装置 1 は、チャンバー（図示せず）内に設置され、該チャンバー内に不活性ガスやその他の雰囲気ガスが充填された状態で作動する。特に、急冷薄帯 8 の酸化を防止するために、雰囲気ガスは、不活性ガスであるのが好ましい。不活性ガスとしては、例えばアルゴンガス、ヘリウムガス、窒素ガス等が挙げられる。

【 0 0 9 1 】

雰囲気ガスの圧力は、特に限定されないが、1 ～ 7 6 0 Torr であるのが好ましい。

【 0 0 9 2 】

筒体 2 内の溶湯 6 の液面には、チャンバーの内圧より高い所定の圧力がかけられている。溶湯 6 は、この筒体 2 内の溶湯 6 の液面に作用する圧力と筒体 2 内における液面の高さに比例してかかる圧力との和と、チャンバー内の雰囲気ガスの圧力との差圧により、ノズル 3 から射出する。

【 0 0 9 3 】

溶湯噴射圧（筒体 2 内の溶湯 6 の液面に作用する圧力と筒体 2 内における液面の高さに比例してかかる圧力との和と、チャンバー内の雰囲気ガスの圧力との差圧）は、特に限定されないが、1 0 ～ 1 0 0 k P a であるのが好ましい。

【 0 0 9 4 】

急冷薄帯製造装置 1 では、筒体 2 内に磁石材料を入れ、コイル 4 により加熱して溶融し、その溶湯 6 をノズル 3 から射出すると、図 1 に示すように、溶湯 6 は、冷却ロール 5 の周面 5 3 に衝突し、パドル（湯溜り）7 を形成した後、回転する冷却ロール 5 の周面 5 3 に引きずられつつ急速に冷却されて凝固し、急冷薄帯 8 が連続的または断続的に形成される。このとき、パドル 7 と周面 5 3 との間にガスが侵入すると、急冷薄帯 8 のロール面 8 1 にディンプル 9 が形成されるが、冷却ロール 5 の周面 5 3 上にディンプル矯正手段（溝 5 4 および凸条 5 5）が設

けられていることにより、ディンプル 9 は分割される。このようにして形成された急冷薄帯 8 は、やがて、そのロール面 8 1 が周面 5 3 から離れ、図 1 中の矢印 B 方向に進行する。

【 0 0 9 5 】

このように、周面 5 3 上にディンプル矯正手段が設けられることにより、ロール面 8 1 における巨大ディンプルの発生が防止され、パドル 7 の不均一な冷却が防止される。その結果、結晶粒径のバラツキが小さく、磁気特性に優れた急冷薄帯 8 が得られる。

【 0 0 9 6 】

また、急冷薄帯 8 を実際に製造するに際しては、必ずしもノズル 3 を冷却ロール 5 の回転軸 5 0 の真上に設置しなくてもよい。

【 0 0 9 7 】

冷却ロール 5 の周速度は、合金溶湯の組成、表面層 5 2 の構成材料（組成）、周面 5 3 の表面性状（特に、周面 5 3 の溶湯 6 に対する濡れ性）等によりその好適な範囲が異なるが、磁気特性向上のために、通常、 $5 \sim 60 \text{ m/秒}$ であるのが好ましく、 $10 \sim 40 \text{ m/秒}$ であるのがより好ましい。冷却ロール 5 の周速度が下限値未満であると、溶湯 6（パドル 7）の冷却速度が低下し、結晶粒径が増大する傾向を示し、磁気特性が低下する場合がある。一方、冷却ロール 5 の周速度が上限値を超えると、逆に冷却速度が大きくなり、非晶質組織が占める割合が大きくなり、その後に、後述する熱処理を施したとしても、磁気特性が十分に向上しない場合がある。

【 0 0 9 8 】

以上のようにして得られた急冷薄帯 8 は、その幅 w および厚さができるだけ均一であるものが好ましい。この場合、急冷薄帯 8 の平均厚さ t は、 $8 \sim 50 \mu\text{m}$ 程度であるのが好ましく、 $10 \sim 40 \mu\text{m}$ 程度であるのがより好ましい。平均厚さ t が下限値未満であると、非晶質組織が占める割合が大きくなり、その後に、後述する熱処理を施したとしても磁気特性が十分に向上しない場合がある。単位時間当たりの生産性も低下する。一方、平均厚さ t が上限値を超えると、フリー面 8 2 側の結晶粒径が粗大化する傾向を示すため、磁気特性が低下する場合があ

る。

【 0 0 9 9 】

このようにして得られる本発明の急冷薄帯 8 は、ロール面 8 1 の少なくとも一部に、冷却ロール 5 の周面 5 3 の表面形状が転写され、冷却ロール 5 の周面 5 3 の表面形状（溝 5 4 または凸条 5 5）に対応する凸条 8 3 または溝 8 4 が形成されている。このようにして、凸条 8 3 または溝 8 4 が形成されることにより、ディンプル 9 が効率よく分割され、ディンプル 9 の 1 個あたりの面積が小さくなっている。また、冷却ロール 5 の周面 5 3 上に形成された溝 5 4 のガス抜き効果により、ディンプル 9 の総面積も減少している。その結果、急冷薄帯 8 の各部位における結晶粒径のバラツキが小さくなり、優れた磁気特性が得られる。

【 0 1 0 0 】

急冷薄帯 8 のロール面 8 1 において、凝固時に形成された $2000\mu\text{m}^2$ 以上のディンプル 9（巨大ディンプル）の占める投影面積の割合は、10%以下であるのが好ましく、5%以下であるのがより好ましい。巨大ディンプルの占める投影面積の割合が10%を超えると、冷却ロール 5 と接触していた部分に比べ、冷却速度が極端に小さい部分（特に、巨大ディンプルの中央部付近）の占める面積の割合が大きくなり、急冷薄帯 8 全体としての磁気特性が低下する。

【 0 1 0 1 】

なお、ディンプルの投影面積の割合は、ロール面 8 1 上の所定の面積中に占める面積率として算出される。特に、ロール面 8 1 上の数箇所以上について算出した面積率の平均値を取るのが好ましい。

【 0 1 0 2 】

急冷薄帯 8 のロール面 8 1 において、凝固時に形成されたディンプル 9 の占める投影面積（総面積）の割合は、40%以下であるのが好ましく、30%以下であるのがより好ましい。ディンプル 9 の占める投影面積（総面積）の割合が大きすぎると、凝固時における冷却速度が全体として低下することとなり、その結果、結晶粒径の粗大化が起こり、得られる急冷薄帯 8 の磁気特性が低下する。

【 0 1 0 3 】

なお、得られた急冷薄帯 8 に対しては、例えば、非晶質組織（アモルファス組

織)の再結晶化の促進、組織の均質化等を目的として、熱処理を施すこともできる。この熱処理の条件としては、例えば、400～900℃で、0.2～300分程度とすることができる。

【0104】

また、この熱処理は、酸化を防止するために、真空または減圧状態下（例えば $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-6}$ Torr）、あるいは窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガス等の不活性ガス中のような、非酸化性雰囲気中で行うのが好ましい。

【0105】

以上のようにして得られた急冷薄帯8は、微細結晶組織、もしくは微細結晶が非晶質組織中に含まれるような組織となり、優れた磁気特性が得られる。

【0106】

なお、以上では、急冷法として、単ロール法を例に説明したが、双ロール法を採用してもよい。このような急冷法は、金属組織（結晶粒）を微細化することができるので、ボンド磁石の磁石特性、特に保磁力等を向上させるのに有効である。

【0107】

[磁石粉末の製造]

以上のようにして製造された急冷薄帯8を粉砕することにより、本発明の磁石粉末が得られる。

【0108】

粉砕の方法は、特に限定されず、例えばボールミル、振動ミル、ジェットミル、ピンミル等の各種粉砕装置、破砕装置を用いて行うことができる。この場合、粉砕は、酸化を防止するために、真空または減圧状態下（例えば $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-6}$ Torr）、あるいは窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガス等の不活性ガス中のような、非酸化性雰囲気中で行うこともできる。

【0109】

磁石粉末の平均粒径は、特に限定されないが、後述するボンド磁石（希土類ボンド磁石）を製造するためのものの場合、磁石粉末の酸化防止と、粉砕による磁気特性劣化の防止とを考慮して、1～300 μ mであるのが好ましく、5～15

0 μ mであるのがより好ましい。

【0 1 1 0】

また、ボンド磁石の成形時のより良好な成形性を得るために、磁石粉末の粒径分布は、ある程度分散されている（バラツキがある）のが好ましい。これにより、得られたボンド磁石の空孔率を低減することができ、その結果、ボンド磁石中の磁石粉末の含有量を同じとしたときに、ボンド磁石の密度や機械的強度をより高めることができ、磁気特性をさらに向上することができる。

【0 1 1 1】

なお、得られた磁石粉末に対しては、例えば、粉碎により導入されたひずみの影響の除去、結晶粒径の制御を目的として、熱処理を施すこともできる。この熱処理の条件としては、例えば、350～850℃で、0.2～300分程度とすることができる。

【0 1 1 2】

また、この熱処理は、酸化を防止するために、真空または減圧状態下（例えば $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-6}$ Torr）、あるいは窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガス等の不活性ガス中のような、非酸化性雰囲気中で行うのが好ましい。

【0 1 1 3】

このような磁石粉末を用いてボンド磁石を製造した場合、該磁石粉末は、結合樹脂との結合性（結合樹脂の濡れ性）が良く、そのため、このボンド磁石は、機械的強度が高く、熱安定性（耐熱性）、耐食性が優れたものとなる。従って、当該磁石粉末は、ボンド磁石の製造に適しており、製造されたボンド磁石は、信頼性の高いものとなる。

【0 1 1 4】

以上のような磁石粉末は、平均結晶粒径が500nm以下であるのが好ましく、200nm以下であるのがより好ましく、10～120nm程度がさらに好ましい。平均結晶粒径が500nmを超えると、磁気特性、特に保磁力および角型性の向上が十分に図れない場合がある。

【0 1 1 5】

特に、磁石材料が前記【4】のような複合組織を有するものである場合、平均

結晶粒径は、1～100nmであるのが好ましく、5～50nmであるのがより好ましい。平均結晶粒径がこのような範囲の大きさであると、ソフト磁性相10とハード磁性相11との間で、より効果的に磁氣的な交換相互作用を生じることとなり、顕著な磁気特性の向上が認められる。

【0116】

[ボンド磁石およびその製造]

次に、本発明のボンド磁石について説明する。

【0117】

本発明のボンド磁石は、好ましくは、前述の磁石粉末を結合樹脂で結合してなるものである。

【0118】

結合樹脂（バインダー）としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれでもよい。

【0119】

熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリアミド（例：ナイロン6、ナイロン46、ナイロン66、ナイロン610、ナイロン612、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン6-12、ナイロン6-66）、熱可塑性ポリイミド、芳香族ポリエステル等の液晶ポリマー、ポリフェニレンオキシド、ポリフェニレンサルファイド、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリエーテル、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリアセタール等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を混合して用いることができる。

【0120】

これらのうちでも、成形性が特に優れており、機械的強度が高いことから、ポリアミド、耐熱性向上の点から、液晶ポリマー、ポリフェニレンサルファイドを主とするものが好ましい。また、これらの熱可塑性樹脂は、磁石粉末との混練性

にも優れている。

【 0 1 2 1 】

このような熱可塑性樹脂は、その種類、共重合化等により、例えば成形性を重視したものや、耐熱性、機械的強度を重視したものというように、広範囲の選択が可能となるという利点がある。

【 0 1 2 2 】

一方、熱硬化性樹脂としては、例えば、ビスフェノール型、ノボラック型、ナフタレン系等の各種エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル（不飽和ポリエステル）樹脂、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、ポリウレタン樹脂等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を混合して用いることができる。

【 0 1 2 3 】

これらのうちでも、成形性が特に優れており、機械的強度が高く、耐熱性に優れるという点から、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂が好ましく、エポキシ樹脂が特に好ましい。また、これらの熱硬化性樹脂は、磁石粉末との混練性、混練の均一性にも優れている。

【 0 1 2 4 】

なお、使用される熱硬化性樹脂（未硬化）は、室温で液状のものでも、固形（粉末状）のものでもよい。

【 0 1 2 5 】

このような本発明のボンド磁石は、例えば次のようにして製造される。磁石粉末と、結合樹脂と、必要に応じ添加剤（酸化防止剤、潤滑剤等）とを混合、混練（例えば、温間混練）してボンド磁石用組成物（コンパウンド）を製造し、このボンド磁石用組成物を用いて、圧縮成形（プレス成形）、押出成形、射出成形等の成形方法により、無磁場中で所望の磁石形状に成形する。結合樹脂が熱硬化性樹脂の場合には、成形後、加熱等によりそれを硬化する。

【 0 1 2 6 】

ここで、前記3種の成形方法のうち、押出成形および射出成形（特に、射出成形）は、形状選択の自由度が広く、生産性が高い等の利点があるが、これらの成

形方法では、良好な成形性を得るために、成形機内におけるコンパウンドの十分な流動性を確保しなければならないため、圧縮成形に比べて、磁石粉末の含有量を多くすること、すなわちボンド磁石を高密度化することができない。しかしながら、本発明では、後述するように、高い磁束密度が得られ、そのため、ボンド磁石を高密度化しなくても優れた磁気特性が得られるので、押出成形、射出成形により製造されるボンド磁石にもその利点を享受することができる。

【 0 1 2 7 】

ボンド磁石中の磁石粉末の含有量（含有率）は、特に限定されず、通常は、成形方法や、成形性と高磁気特性との両立を考慮して決定される。具体的には、75～99.5wt%程度であるのが好ましく、85～97.5wt%程度であるのがより好ましい。

【 0 1 2 8 】

特に、ボンド磁石が圧縮成形により製造されたものの場合には、磁石粉末の含有量は、90～99.5wt%程度であるのが好ましく、93～98.5wt%程度であるのがより好ましい。

【 0 1 2 9 】

また、ボンド磁石が押出成形または射出成形により製造されたものの場合には、磁石粉末の含有量は、75～98wt%程度であるのが好ましく、85～97wt%程度であるのがより好ましい。

【 0 1 3 0 】

ボンド磁石の密度 ρ は、それに含まれる磁石粉末の比重、磁石粉末の含有量、空孔率等の要因により決定される。本発明のボンド磁石において、その密度 ρ は特に限定されないが、4.5～6.6Mg/m³程度であるのが好ましく、5.5～6.4Mg/m³程度であるのがより好ましい。

【 0 1 3 1 】

本発明では、磁石粉末の磁束密度、保磁力が大きいので、ボンド磁石に成形した場合に、磁石粉末の含有量が多い場合はもちろんのこと、含有量が比較的少ない場合でも、優れた磁気特性（特に、高い最大磁気エネルギー積（BH）_{max}）が得られる。

【 0 1 3 2 】

本発明のボンド磁石の形状、寸法等は特に限定されず、例えば、形状に関しては、例えば、円柱状、角柱状、円筒状（リング状）、円弧状、平板状、湾曲板状等のあらゆる形状のものが可能であり、その大きさも、大型のものから超小型のものまであらゆる大きさのものが可能である。特に、小型化、超小型化された磁石に有利であることは、本明細書中で度々述べている通りである。

【 0 1 3 3 】

本発明のボンド磁石は、保磁力（室温での固有保磁力） H_{cJ} が $320 \sim 1200 \text{ kA/m}$ であるのが好ましく、 $400 \sim 800 \text{ kA/m}$ がより好ましい。保磁力が前記下限値未満では、逆磁場がかかったときの減磁が顕著になり、また、高温における耐熱性が劣る。また、保磁力が前記上限値を超えると、着磁性が低下する。従って、保磁力 H_{cJ} を上記範囲とすることにより、ボンド磁石（特に、円筒状磁石）に多極着磁等をするような場合に、十分な着磁磁場が得られないときでも、良好な着磁が可能となり、十分な磁束密度が得られ、高性能なボンド磁石を提供することができる。

【 0 1 3 4 】

本発明のボンド磁石は、最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\max}$ が 40 kJ/m^3 以上であるのが好ましく、 50 kJ/m^3 以上であるのがより好ましく、 $70 \sim 120 \text{ kJ/m}^3$ であるのがさらに好ましい。最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\max}$ が 40 kJ/m^3 未満であると、モータ用に用いた場合、その種類、構造によっては、十分なトルクが得られない。

【 0 1 3 5 】

以上説明したように、本実施形態の冷却ロール 5 によれば、ディンプル矯正手段として溝 54 および凸条 55 が設けられているため、ロール面 81 に形成されるディンプル 9 を分割することができる。そのため、巨大ディンプルの発生を防止し、パドル 7 の各部位における冷却速度の差を小さくすることができる。その結果、急冷薄帯 8 においては、結晶粒径のバラツキが小さく、高い磁気特性が安定して得られる。

【 0 1 3 6 】

したがって、前記急冷薄帯 8 から得られるボンド磁石は、優れた磁気特性を有している。また、ボンド磁石の製造に際し、高密度化を追求しなくても高い磁気特性を得ることができるため、成形性、寸法精度、機械的強度、耐食性、耐熱性等の向上を図ることができる。

【0137】

次に、本発明の冷却ロール 5 の第 2 実施形態について、説明する。

図 1 3 は、本発明の冷却ロールの第 2 実施形態を示す正面図、図 1 4 は、図 1 3 に示す冷却ロールの拡大断面図である。以下、第 2 実施形態の冷却ロールについて、前記第 1 実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項の説明は省略する。

【0138】

図 1 3 に示すように、ディンプル矯正手段である溝 5 4（または凸条 5 5）は、冷却ロール 5 の回転軸 5 0 を中心とする螺旋状に形成されている。溝 5 4（または凸条 5 5）がこのような形状であると、比較的容易に、周面 5 3 全体にわたり溝 5 4（または凸条 5 5）を形成することができる。例えば、冷却ロール 5 を一定速度で回転させておき、旋盤等の切削工具を回転軸 5 0 に対して平行に、一定速度で移動させながら、冷却ロール 5 の外周部を切削することによりこのような溝 5 4 を形成することができる。

【0139】

なお、螺旋状の溝 5 4（または凸条 5 5）は、1 条（1 本）であっても、2 条（2 本）以上であってもよい。

【0140】

溝 5 4（または凸条 5 5）の長手方向と、冷却ロール 5 の回転方向とのなす角 θ （絶対値）は、 30° 以下であるのが好ましく、 20° 以下であるのがより好ましい。 θ が 30° 以下であると、冷却ロール 5 のあらゆる周速度において、周面 5 3 とパドル 7 との間に侵入したガスを効率よく排出することができる。そのため、ディンプルの分割がさらに起こり易くなり、ディンプルの 1 個あたりの面積、ディンプルの総面積は、さらに小さくなる。

【0141】

周面 53 上の各部位において、 θ の値は、一定であっても、一定でなくてもよい。また、溝 54（または凸条 55）を 2 条以上有する場合、それぞれの溝 54（または凸条 55）について、 θ は、同一であっても、異なってもよい。

【0142】

溝 54 は、周面 53 の縁部 56 において、開口部 57 で開口している。これにより、周面 53 とパドル 7 との間から溝 54 に排出されたガスがこの開口部 57 から冷却ロール 5 の側方へ排出されるため、排出されたガスが再び周面 53 とパドル 7 との間に侵入するのを効果的に防止することができ、ディンプルを矯正する効果がさらに向上する。図示の構成では、溝 54 は、両縁部に開口しているが、一方の縁部にのみ開口していてもよい。

【0143】

次に、本発明の冷却ロール 5 の第 3 実施形態について、説明する。

図 15 は、本発明の冷却ロールの第 3 実施形態を示す正面図、図 16 は、図 15 に示す冷却ロールの拡大断面図である。以下、第 3 実施形態の冷却ロールについて、前記第 1 実施形態、第 2 実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項の説明は省略する。

【0144】

図 15 に示すように、周面 53 上には、螺旋の回転方向が互いに逆向きである少なくとも 2 本の溝 54 が形成されている。これらの溝 54 は、多点で交差している。

【0145】

このように、螺旋の回転方向が逆向きである溝 54 が形成されることにより、製造された急冷薄帯 8 が右巻きの溝から受ける横方向の力と左巻きの溝から受ける横方向の力とが相殺され、急冷薄帯 8 の図 15 中の横方向の移動が抑制され、進行方向が安定する。

【0146】

また、図 15 中、 θ_1 、 θ_2 で示すそれぞれの回転方向の溝 54 の長手方向と冷却ロール 5 の回転方向とのなす角（絶対値）は、前述した θ と同様な範囲の値であるのが好ましい。

【 0 1 4 7 】

次に、本発明の冷却ロール 5 の第 4 実施形態について、説明する。

図 1 7 は、本発明の冷却ロールの第 4 実施形態を示す正面図、図 1 8 は、図 1 7 に示す冷却ロールの拡大断面図である。以下、第 4 実施形態の冷却ロールについて、前記第 1 実施形態～第 3 実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項の説明は省略する。

【 0 1 4 8 】

図 1 7 に示すように、複数の溝 5 4 が、冷却ロール 5 の周面の幅方向のほぼ中央から両縁部 5 5 の方向に、ハの字状に形成されている。

【 0 1 4 9 】

このような溝 5 4 が形成された冷却ロール 5 を用いた場合、その回転方向との組み合わせにより、周面 5 3 とパドル 7 との間に侵入したガスをさらに高い効率で排出することができる。そのため、ディンプルの分割がさらに起こり易くなり、ディンプルの 1 個あたりの面積、ディンプルの総面積は、さらに小さくなる。

【 0 1 5 0 】

また、このようなパターンの溝が形成された場合、冷却ロール 5 の回転に伴って生じる、図 1 7 中、左右の両溝 5 4 からの力がつりあうことにより、冷却ロール 5 の幅方向のほぼ中央に急冷薄帯 8 がよせられるため、急冷薄帯 8 の進行方向が安定する。

【 0 1 5 1 】

なお、本発明では、ディンプル矯正手段の形状等の諸条件は、前述した第 1 実施形態～第 4 実施形態に限定されるものではない。

【 0 1 5 2 】

例えば、溝 5 4 は、図 1 9 に示すように間欠的に形成されたものであってもよい。また、溝 5 4 の断面形状は、特に限定されず、例えば、図 2 0、図 2 1 に示すようなものであってもよい。

【 0 1 5 3 】

また、ディンプル矯正手段は、前述したような溝や凸条に限らず、ディンプルを矯正する機能を有するものであればいかなるものでもよい。

【 0 1 5 4 】

このような冷却ロール 5 でも、前述した第 1 実施形態～第 4 実施形態の冷却ロール 5 と同様の効果が得られる。

【 0 1 5 5 】

【実施例】

以下、本発明の具体的実施例について説明する。

【 0 1 5 6 】

(実施例 1)

図 1 ～図 3 に示す周面にディンプル矯正手段を有する冷却ロールを製造し、この冷却ロールを備えた図 1 に示す構成の急冷薄帯製造装置を用意した。

【 0 1 5 7 】

冷却ロールは、以下のようにして製造した。

まず、銅製のロール基材（直径 2 0 0 m m、幅 3 0 m m）を用意し、その周面に切削加工を施し、ほぼ鏡面（表面粗さ $R_a 0.07 \mu m$ ）とした。

【 0 1 5 8 】

その後、さらに、切削加工を施し、ロール基材の回転方向に対し、ほぼ平行な溝を形成した。

【 0 1 5 9 】

このロール基材の外周面に、セラミックスである ZrC の表面層をイオンプレーティングにより形成し、図 1 ～図 3 に示すような冷却ロールを得た。

【 0 1 6 0 】

このようにして得られた冷却ロール 5 を備えた急冷薄帯製造装置 1 を用いて、以下に述べるような方法で合金組成が $(Nd_{0.75}Pr_{0.2}Dy_{0.05})_{9.0}Fe_{bal}Co_{8.2}B_{5.6}$ で表される急冷薄帯を製造した。

【 0 1 6 1 】

まず、 Nd 、 Pr 、 Dy 、 Fe 、 Co 、 B の各原料を秤量して母合金インゴットを鑄造した。

【 0 1 6 2 】

急冷薄帯製造装置 1 において、底部にノズル（円孔オリフィス） 3 を設けた石

英管内に前記母合金インゴットを入れた。急冷薄帯製造装置 1 が収納されているチャンバー内を脱気した後、不活性ガス（ヘリウムガス）を導入し、所望の温度および圧力の雰囲気とした。

【 0 1 6 3 】

その後、石英管内の母合金インゴットを高周波誘導加熱により溶解し、さらに、冷却ロール 5 の周速度を 28 m/秒 とし、溶湯 6 の噴射圧（石英管の内圧と筒体 2 内における液面の高さに比例してかかる圧力との和と、雰囲気圧との差圧）を 40 kPa 、雰囲気ガスの圧力を 60 kPa としたうえで、溶湯 6 を冷却ロール 5 の回転軸 50 のほぼ真上から冷却ロール 5 の頂部の周面 53 に向けて噴射し、急冷薄帯 8 を連続的に作製した。

【 0 1 6 4 】

（実施例 2 ～ 7）

溝および凸条の形状を図 13、図 14 に示すようなものとした以外は実施例 1 と同様にして冷却ロールを製造した。このとき、溝の平均幅、凸条の平均幅、溝の平均深さ（凸条の平均高さ）、および並設された溝（凸条）の平均ピッチを種々変化させて、6 種の冷却ロールを製造した。なお、いずれも、3 本の切削工具を等間隔に設置した旋盤を用いて、併設された溝のピッチが周面上の各部位において、ほぼ一定となるように 3 条の溝を形成した。なお、溝の長手方向と冷却ロールの回転方向とのなす角 θ は、いずれの冷却ロールも 5° であった。実施例 1 で用いた急冷薄帯製造装置の冷却ロールをこれらの冷却ロールに順次交換し、実施例 1 と同様にして急冷薄帯を製造した。

【 0 1 6 5 】

（実施例 8）

溝および凸条の形状を図 15、図 16 に示すようなものとした以外は実施例 2 と同様にして冷却ロールを製造し、急冷薄帯製造装置の冷却ロールをこの冷却ロールに交換して、実施例 1 と同様にして急冷薄帯を製造した。なお、溝の長手方向と冷却ロールの回転方向とのなす角 θ_1 、 θ_2 は、いずれも 15° であった。

【 0 1 6 6 】

（実施例 9）

溝および凸条の形状を図 1 7、図 1 8 に示すようなものとした以外は実施例 1 と同様にして冷却ロールを製造し、急冷薄帯製造装置の冷却ロールをこの冷却ロールに交換して、実施例 1 と同様にして急冷薄帯を製造した。なお、溝の長手方向と冷却ロールの回転方向とのなす角 θ_1 、 θ_2 は、いずれも 20° であった。

【0 1 6 7】

(比較例)

ロール基材の外周を切削加工によりほぼ鏡面とした後、溝、凸条を設けずに、そのまま表面層を形成したものを製造した以外は、実施例 1 と同様にして冷却ロールを製造し、急冷薄帯製造装置の冷却ロールをこの冷却ロールに交換して、実施例 1 と同様にして急冷薄帯を製造した。

【0 1 6 8】

前記実施例 1 ～ 9 および比較例の各冷却ロールの表面層の厚さは、いずれも、 $7\mu\text{m}$ であった。なお、表面層の形成後、該表面層に対し、機械加工は施さなかった。各冷却ロールについて、溝の幅 L_1 (平均値)、凸条の幅 L_2 (平均値)、溝の深さ (凸条の高さ) L_3 (平均値)、並設された溝 (凸条) のピッチ L_4 (平均値)、冷却ロールの周面上における溝の占める投影面積の割合の測定値を表 1 に示す。

【0 1 6 9】

【表 1】

冷却ロールの周面、溝および凸条の条件

	溝の平均幅 L_1 (μm)	凸条の平均幅 L_2 (μm)	溝の平均深さ L_3 (μm)	平均ピッチ L_4 (μm)	溝の占める 投影面積の割合 (%)
実施例 1	22.5	2.5	3.5	25.0	90
実施例 2	20.0	40.0	3.0	40.0	50
実施例 3	10.0	12.0	1.5	12.0	83
実施例 4	27.0	90.0	8.0	90.0	30
実施例 5	30.0	50.0	2.0	50.0	60
実施例 6	28.0	68.0	5.3	68.0	41
実施例 7	5.0	7.5	1.0	7.5	67
実施例 8	9.5	15.0	2.5	15.0	63
実施例 9	20.0	30.0	1.5	30.0	67
比較例	-	-	-	-	-

【 0 1 7 0 】

前記実施例 1 ～ 9 および比較例の急冷薄帯について、走査型電子顕微鏡（SEM）を用い、ロール面の表面形状の観察を行った。その結果、実施例 1 ～ 9 の各急冷薄帯では、いずれも、冷却ロールの周面の表面形状（溝または凸条）が転写され、対応する凸条または溝が形成されており、これにより、ディンプルが分割されている様子が確認された。これに対し、比較例の急冷薄帯では、巨大ディンプルが数多く存在することが確認された。実施例 3 の急冷薄帯について、電子顕微鏡写真を図 2 2 に示す。

【 0 1 7 1 】

前記実施例 1 ～ 9 および比較例の急冷薄帯に対し、それぞれ、下記①および②の評価を行った。

【 0 1 7 2 】

①急冷薄帯の磁気特性

それぞれの急冷薄帯について、長さ約 5 c m の急冷薄帯を取り出し、さらにそこから長さ約 7 m m のサンプルを 5 サンプル連続して作製し、それぞれのサンプルについて平均厚さ t 、ロール面における巨大ディンプル（ $2000 \mu\text{m}^2$ 以上）の占める投影面積の割合、ロール面におけるディンプルの占める投影面積（総面積）の割合および磁気特性を測定した。

【 0 1 7 3 】

平均厚さ t は、マイクロ스코プにより 1 サンプルにつき 2 0 箇所の測定点で測定し、これを平均した値とした。ロール面における巨大ディンプル（ $2000 \mu\text{m}^2$ 以上）の占める投影面積の割合およびロール面におけるディンプルの占める投影面積（総面積）の割合は、走査型電子顕微鏡（SEM）による観察の結果から求めた。磁気特性は、振動試料型磁力計（VSM）を用いて保磁力 H_{cJ} （k A / m）および最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\text{max}}$ （k J / m³）を測定した。測定に際しては、急冷薄帯の長軸方向を印加磁界方向とした。なお、反磁界補正は行わなかった。

【 0 1 7 4 】

②ボンド磁石の磁気特性

それぞれの急冷薄帯に対し、アルゴンガス雰囲気中で、 $675^{\circ}\text{C} \times 300$ 秒の熱処理を施した。

【0175】

これら熱処理を施した急冷薄帯を粉砕し、平均粒径 $75\ \mu\text{m}$ の磁石粉末を得た。

【0176】

このようにして得られた磁石粉末について、その相構成を分析するため、 $\text{Cu-K}\alpha$ を用い回折角 $20^{\circ} \sim 60^{\circ}$ にて X 線回折を行った。回折パターンからハード磁性相である $\text{R}_2(\text{Fe} \cdot \text{Co})_{14}\text{B}$ 型相と、ソフト磁性相である $\alpha-(\text{Fe}, \text{Co})$ 型相の回折ピークが確認でき、透過型電子顕微鏡 (TEM) による観察結果から、いずれも、複合組織 (ナノコンポジット組織) を形成していることが確認された。また、各磁石粉末について、各相の平均結晶粒径を測定した。

【0177】

次に、各磁石粉末とエポキシ樹脂とを混合し、ボンド磁石用組成物 (コンパウンド) を作製した。このとき、磁石粉末とエポキシ樹脂との配合比率 (重量比) は、各サンプルについてほぼ等しい値とした。すなわち、各サンプル中の磁石粉末の含有量 (含有率) は、約 $97.5\ \text{wt}\%$ であった。

【0178】

次いで、このコンパウンドを粉砕して粒状とし、この粒状物を秤量してプレス装置の金型内に充填し、温度 120°C 、圧力 $600\ \text{MPa}$ で圧縮成形 (無磁場中) してから冷却し、離型した後、 175°C で加熱硬化させて、直径 $10\ \text{mm} \times$ 高さ $8\ \text{mm}$ の円柱状のボンド磁石を得た。

【0179】

これらのボンド磁石について、磁場強度 $3.2\ \text{MA/m}$ のパルス着磁を施した後、直流自記磁束計 (東英工業 (株) 製、TRF-5BH) にて最大印加磁場 $2.0\ \text{MA/m}$ で磁気特性 (磁束密度 B_r 、保磁力 H_{cJ} および最大磁気エネルギー積 $(BH)_{\text{max}}$) を測定した。測定時の温度は、 23°C (室温) であった。

これらの結果を表 2～表 4 に示す。

【0180】

【表2】

急冷薄帯の特性 (実施例1～5)

	サンプル No.	平均厚さ (μm)	巨大ディンプルの 占める投影面積の割合 (%)	ディンプルの 総面積の割合 (%)	H_{cJ} (kA/m)	B_r (T)	(BH) $_{\text{max}}$ (kJ/m^3)
実施例1	1	19	1.9	20	562	1.05	155
	2	19	1.5	18	564	1.04	154
	3	20	2.2	23	566	1.02	150
	4	20	1.6	19	561	1.03	152
	5	20	2.1	22	559	1.03	153
実施例2	1	20	2.3	26	548	1.02	149
	2	21	2.0	20	554	1.02	150
	3	22	2.2	23	546	1.00	145
	4	21	2.5	27	549	1.01	147
	5	21	2.2	22	550	1.01	148
実施例3	1	19	0.2	19	561	1.05	155
	2	18	0.1	12	570	1.06	162
	3	19	0.2	18	562	1.05	156
	4	19	0.2	16	563	1.05	158
	5	18	0.1	14	568	1.06	160
実施例4	1	19	3.5	31	538	0.99	144
	2	20	3.8	34	553	0.98	142
	3	25	3.6	32	542	0.96	140
	4	24	3.7	35	540	0.96	139
	5	21	3.7	32	550	0.97	141
実施例5	1	19	2.2	25	558	1.03	152
	2	22	2.1	23	552	1.02	151
	3	20	1.7	19	563	1.05	156
	4	21	1.9	20	560	1.04	154
	5	20	2.0	21	558	1.04	153

【0181】

【表 3】

急冷薄帯の特性 (実施例 6 ～ 9、比較例)

	サンプル No.	平均厚さ (μm)	巨大ディンプルの 占める投影面積の割合 (%)	ディンプルの 総面積の割合 (%)	H_{cJ} (kA/m)	B_r (T)	$(BH)_{\text{max}}$ (kJ/m^3)
実施例 6	1	23	2.1	25	557	1.01	148
	2	22	1.7	20	555	1.03	151
	3	21	2.0	23	554	1.02	149
	4	22	1.5	24	552	1.02	150
	5	23	1.8	22	548	1.01	147
実施例 7	1	18	0.3	13	570	1.06	160
	2	19	0.5	20	569	1.06	159
	3	18	0.2	11	572	1.07	162
	4	20	0.3	15	564	1.04	157
	5	19	0.4	18	567	1.05	158
実施例 8	1	21	0.8	18	552	1.04	153
	2	20	0.7	17	556	1.03	152
	3	19	0.9	16	562	1.05	156
	4	21	1.2	21	555	1.03	151
	5	19	1.0	19	560	1.04	154
実施例 9	1	22	2.3	26	557	1.01	148
	2	20	2.0	24	562	1.02	150
	3	21	1.8	20	560	1.01	149
	4	21	2.1	25	559	1.03	152
	5	19	1.9	23	564	1.02	151
比較例	1	19	15.5	43	330	0.81	73
	2	32	18.0	46	280	0.67	57
	3	20	22.3	53	303	0.77	69
	4	25	19.0	49	319	0.79	70
	5	17	25.5	58	295	0.75	60

【0182】

【表 4】

磁石粉末の平均結晶粒径とボンド磁石の磁気特性

	平均結晶粒径 (nm)	H_{cJ} (kA/m)	B_r (T)	$(BH)_{max}$ (kJ/m ³)
実施例 1	29	562	0.87	110
実施例 2	35	550	0.84	103
実施例 3	25	565	0.89	117
実施例 4	40	543	0.82	98
実施例 5	30	560	0.87	108
実施例 6	34	553	0.84	104
実施例 7	27	568	0.88	116
実施例 8	32	558	0.86	107
実施例 9	33	561	0.86	105
比較例	67	300	0.68	49

【0183】

表 2 および表 3 から明らかなように、実施例 1～9 の急冷薄帯では、巨大ディンプルの占める面積の割合が 0.1～3.8% と小さく、ディンプルの占める面積（総面積）の割合も小さくなっている。また、磁気特性のバラツキが小さく、全体として磁気特性が高い。これは、以下のような理由によるものと推定される。

【0184】

実施例 1～9 の冷却ロールは、その周面上に、ディンプル矯正手段を有している。そのため、急冷薄帯のロール面への巨大ディンプルの発生は、防止または抑制され、ディンプルの 1 個あたりの面積が小さくなり、ディンプルの占める面積（総面積）の割合も小さくなる。このため、パドルの各部位における冷却速度の差は小さくなり、結果として、結晶粒径、磁気特性のバラツキの小さい急冷薄帯が得られるものと考えられる。

【0185】

これに対し、比較例の急冷薄帯では、巨大ディンプルの占める面積の割合が 15.5～25.5% と大きく、ディンプルの占める面積（総面積）の割合も本発明の急冷薄帯に比べ、大きくなっている。また、連続した急冷薄帯から切り出したサンプルであるにもかかわらず、磁気特性のバラツキが大きい。これは、以下のような理由によるものと推定される。

【 0 1 8 6 】

周面とパドルとの間に侵入したガスにより、急冷薄帯のロール面に巨大なディンプルが形成される。このため、周面に接触している部分における冷却速度は大きいものに対し、周面に接触していない部分（特に、巨大ディンプルの中央部付近）における冷却速度は低下し、結晶粒径の粗大化が起こる。その結果、得られる急冷薄帯の磁気特性のバラツキは大きくなると考えられる。

【 0 1 8 7 】

また、表 4 から明らかなように、実施例 1 ～ 9 のボンド磁石では、優れた磁気特性が得られているのに対し、比較例のボンド磁石は、低い磁気特性しか有していない。

【 0 1 8 8 】

これは、実施例 1 ～ 9 では、磁気特性が高く、かつ磁気特性のバラツキの小さい急冷薄帯から得られる磁石粉末を用いているのに対し、比較例では、磁気特性のバラツキの大きい急冷薄帯から得られる磁石粉末を用いているため、全体としての磁気特性が低下しているものであると考えられる。

【 0 1 8 9 】

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、次のような効果が得られる。

【 0 1 9 0 】

・冷却ロールの周面にディンプル矯正手段が設けられているため、製造される急冷薄帯における巨大ディンプルの発生が防止または抑制され、ディンプルの 1 個あたりの面積も小さくなる。また、ロール面におけるディンプルの総面積も小さくなる。そのため、パドルの各部位における冷却速度の差が小さくなり、製造される急冷薄帯においては、高い磁気特性が安定して得られる。

【 0 1 9 1 】

・特に、表面層の形成材料、厚さ、ディンプル矯正手段としての、溝、凸条の寸法、ピッチ等の条件を適宜選択することにより、製造される急冷薄帯のロール面におけるディンプルの 1 個あたりの面積や総面積等をコントロールすることができ、優れた磁気特性の磁石材料を得ることができる。

【 0 1 9 2 】

・磁石粉末がソフト磁性相とハード磁性相とを有する複合組織で構成されることにより、磁化が高く、優れた磁気特性を発揮し、特に固有保磁力と角型性が改善される。

【 0 1 9 3 】

・高い磁束密度が得られるので、等方性であっても、高磁気特性を持つボンド磁石が得られる。特に、従来の等方性ボンド磁石に比べ、より小さい体積のボンド磁石で同等以上の磁気性能を発揮することができるので、より小型で高性能のモータを得ることが可能となる。

【 0 1 9 4 】

・また、高い磁束密度が得られることから、ボンド磁石の製造に際し、高密度化を追求しなくても十分に高い磁気特性を得ることができ、その結果、成形性の向上と共に、寸法精度、機械的強度、耐食性、耐熱性（熱的安定性）等のさらなる向上が図れ、信頼性の高いボンド磁石を容易に製造することが可能となる。

【 0 1 9 5 】

・着磁性が良好なので、より低い着磁磁場で着磁することができ、特に多極着磁等を容易かつ確実に行うことができ、かつ高い磁束密度を得ることができる。

【 0 1 9 6 】

・高密度化を要求されないことから、圧縮成形法に比べて高密度の成形がしにくい押出成形法や射出成形法によるボンド磁石の製造にも適し、このような成形方法で成形されたボンド磁石でも、前述したような効果が得られる。よって、ボンド磁石の成形方法の選択の幅、さらには、それによる形状選択の自由度が広がる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の冷却ロールの第 1 実施形態と、その冷却ロールを用いて薄帯状磁石材料を製造する装置（急冷薄帯製造装置）の構成例とを模式的に示す斜視図である。

【図 2】

図 1 に示す冷却ロールの正面図である。

【図 3】

図 1 に示す冷却ロールの周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 4】

従来の薄帯状磁石材料を単ロール法により製造する装置（急冷薄帯製造装置）における溶湯の冷却ロールへの衝突部位付近の状態を模式的に示す断面図である。

【図 5】

図 1 に示す薄帯状磁石材料を製造する装置（急冷薄帯製造装置）における溶湯の冷却ロールへの衝突部位付近の状態を模式的に示す断面図である。

【図 6】

従来の薄帯状磁石材料を単ロール法により製造する装置（急冷薄帯製造装置）で製造された薄帯状磁石材料の表面形状を模式的に示す斜視図である。

【図 7】

図 1 に示す薄帯状磁石材料を製造する装置（急冷薄帯製造装置）で製造された薄帯状磁石材料の表面形状を模式的に示す斜視図である。

【図 8】

ディンプル矯正手段の形成方法を説明するための図である。

【図 9】

ディンプル矯正手段の形成方法を説明するための図である。

【図 1 0】

本発明の磁石粉末における複合組織（ナノコンポジット組織）の一例を模式的に示す図である。

【図 1 1】

本発明の磁石粉末における複合組織（ナノコンポジット組織）の一例を模式的に示す図である。

【図 1 2】

本発明の磁石粉末における複合組織（ナノコンポジット組織）の一例を模式的に示す図である。

【図 1 3】

本発明の冷却ロールの第 2 実施形態を模式的に示す正面図である。

【図 1 4】

図 1 3 に示す冷却ロールの周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 1 5】

本発明の冷却ロールの第 3 実施形態を模式的に示す正面図である。

【図 1 6】

図 1 5 に示す冷却ロールの周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 1 7】

本発明の冷却ロールの第 4 実施形態を模式的に示す正面図である。

【図 1 8】

図 1 7 に示す冷却ロールの周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 1 9】

本発明の冷却ロールの他の実施形態を模式的に示す正面図である。

【図 2 0】

本発明の冷却ロールの他の実施形態の周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 2 1】

本発明の冷却ロールの他の実施形態の周面付近の断面形状を模式的に示す図である。

【図 2 2】

本発明の薄帯状磁石材料の表面形状を示す電子顕微鏡写真である。

【図 2 3】

従来の薄帯状磁石材料を単ロール法により製造する装置（急冷薄帯製造装置）における溶湯の冷却ロールへの衝突部位付近の状態を示す断面側面図である。

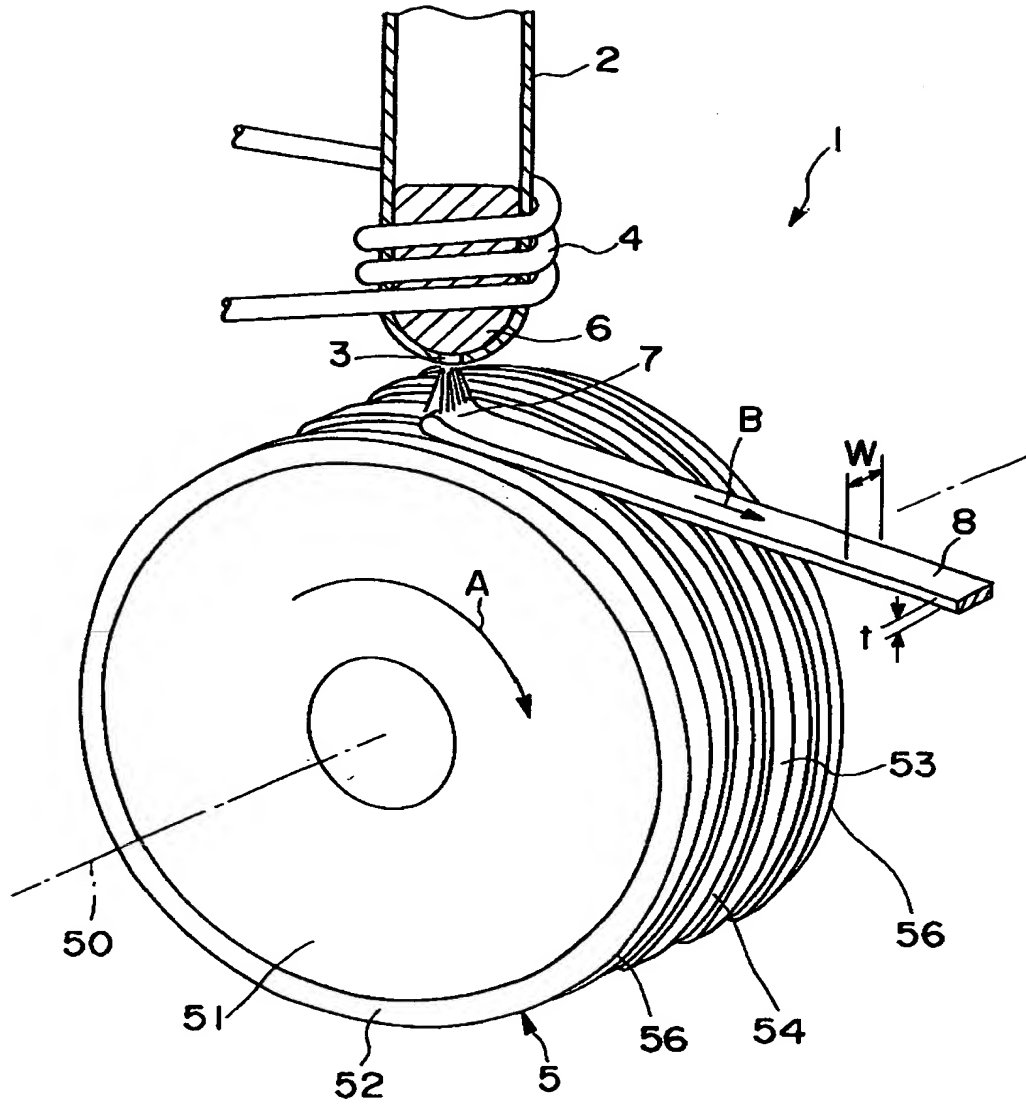
【符号の説明】

- | | |
|---|----------|
| 1 | 急冷薄帯製造装置 |
| 2 | 筒体 |
| 3 | ノズル |

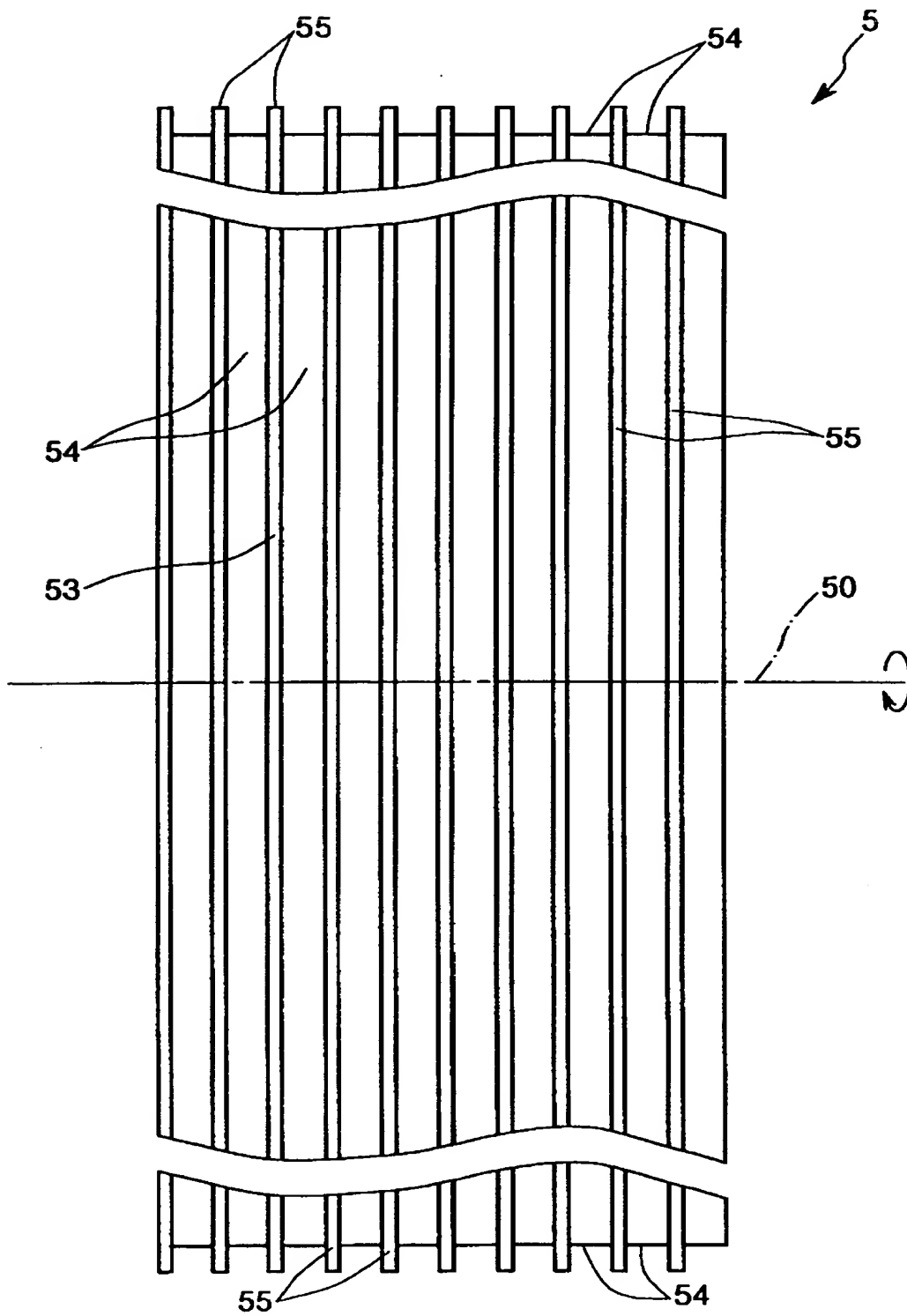
4	コイル
5、500	冷却ロール
50	回転軸
51	ロール基材
52	表面層
53、530	周面
54	溝
55	凸条
56	縁部
57	開口部
58	突起部
6、60	溶湯
7、70	パドル
710	凝固界面
8、80	急冷薄帯
81、810	ロール面
82	フリー面
83	凸条
84	溝
9	ディンプル
10	ソフト磁性相
11	ハード磁性相

【書類名】 図面

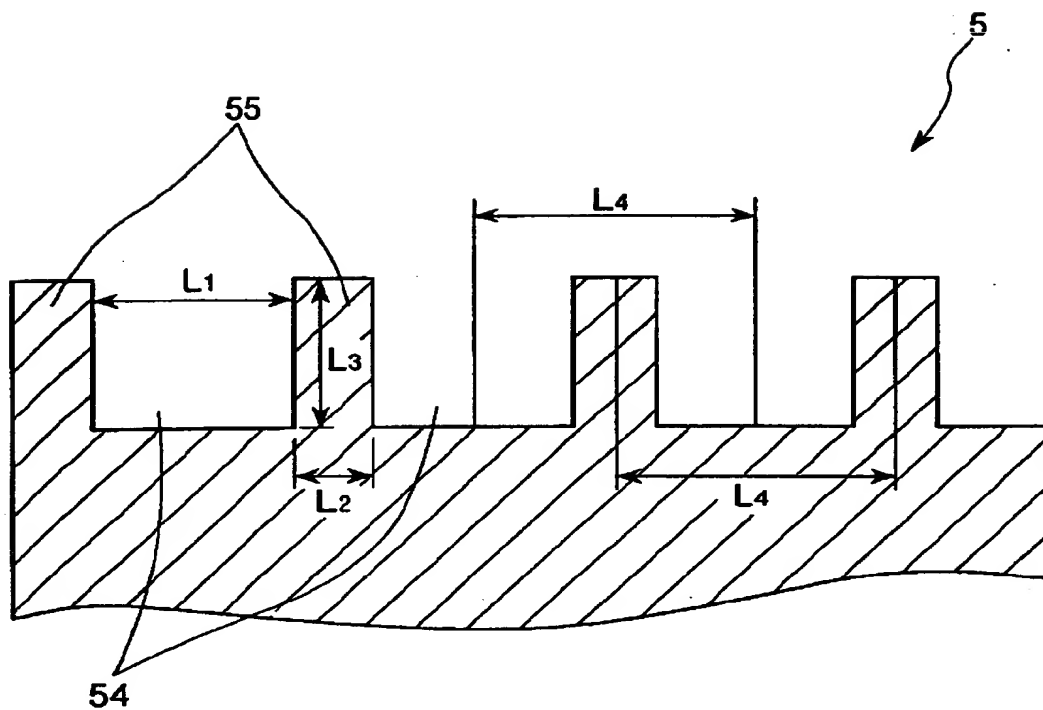
【図 1】



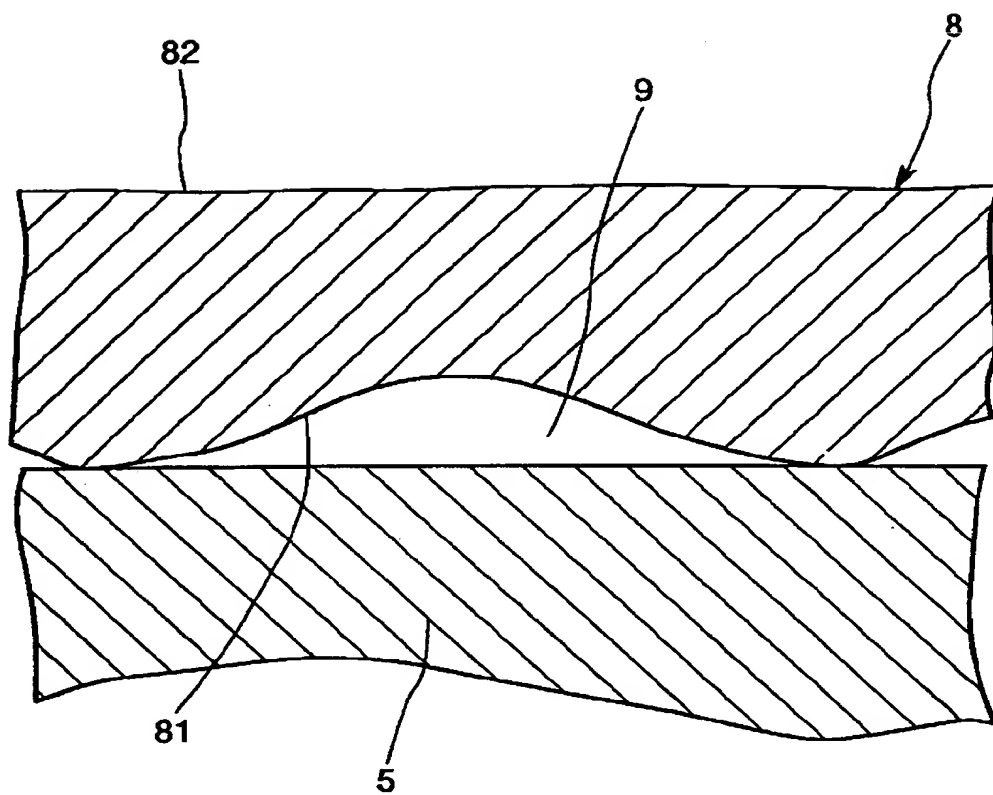
【図2】



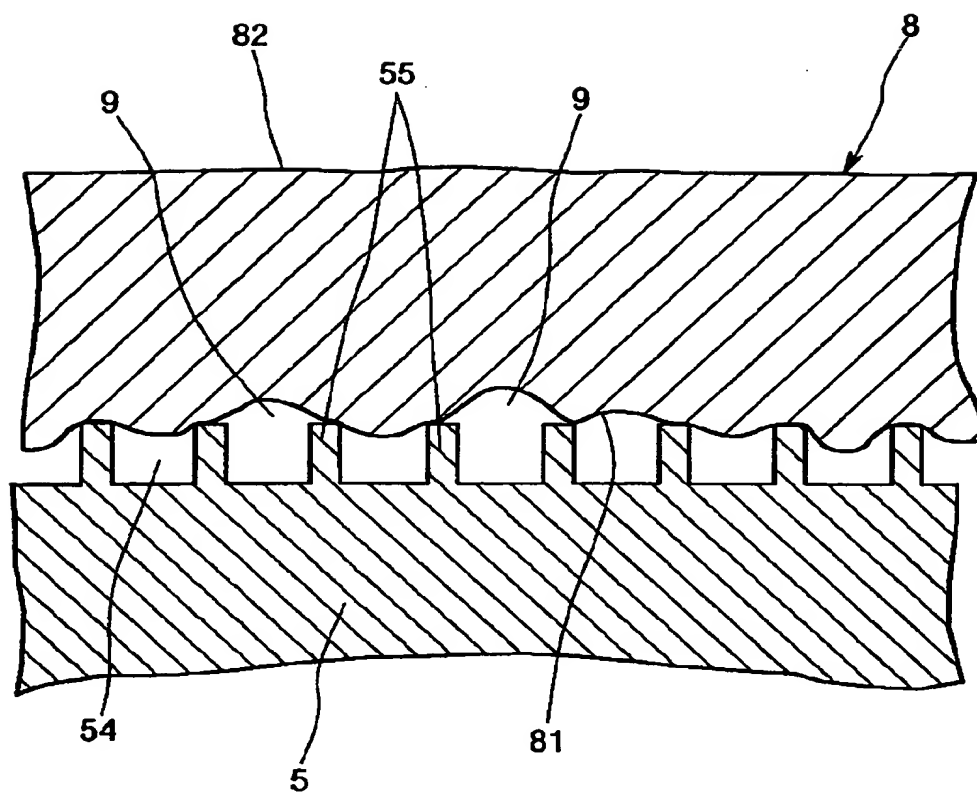
【図3】



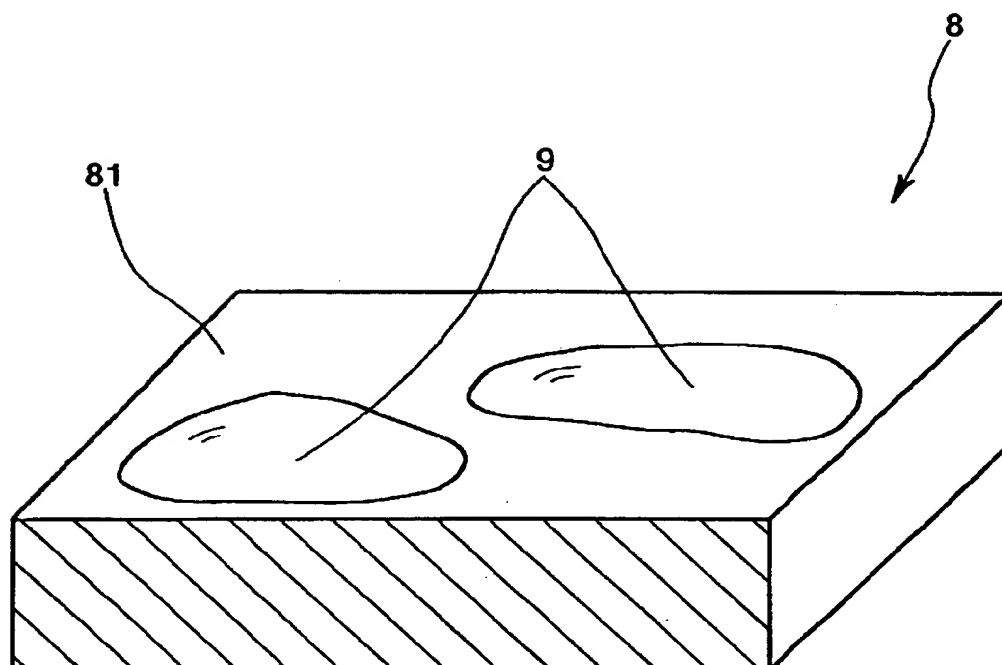
【図4】



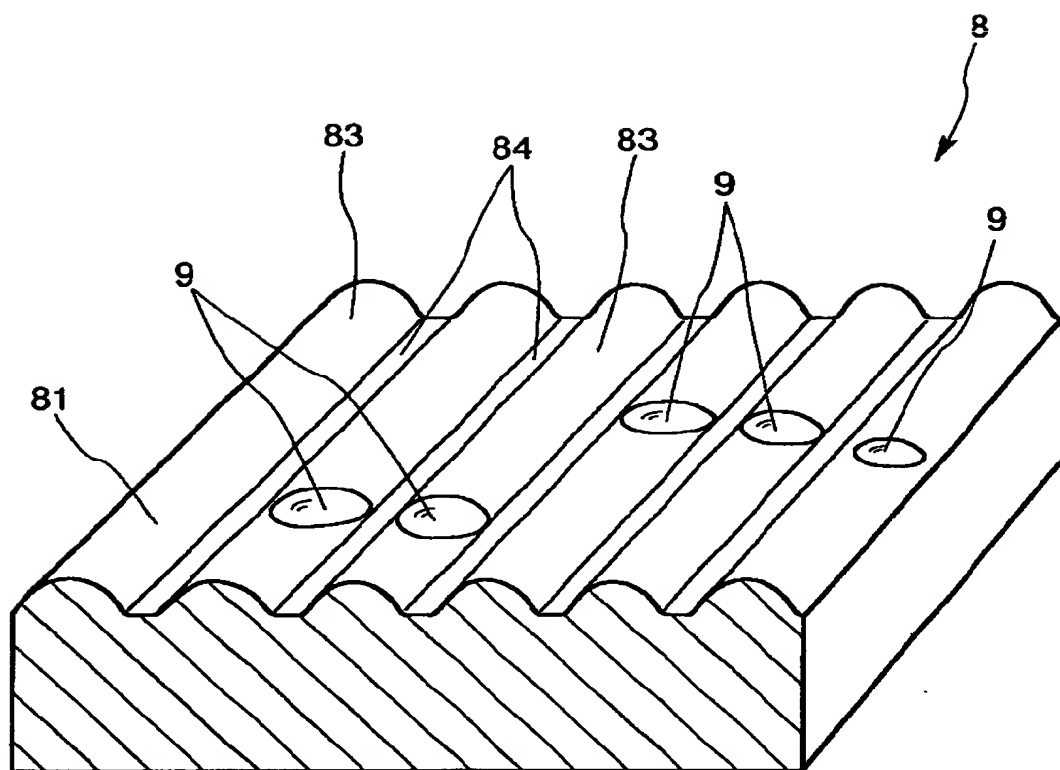
【図 5】



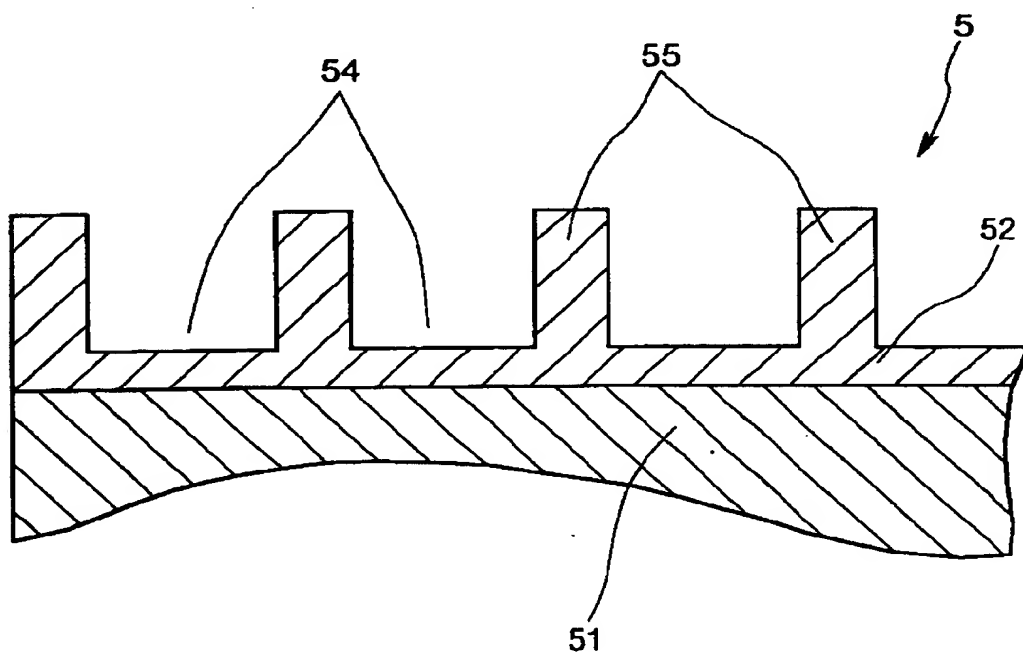
【図6】



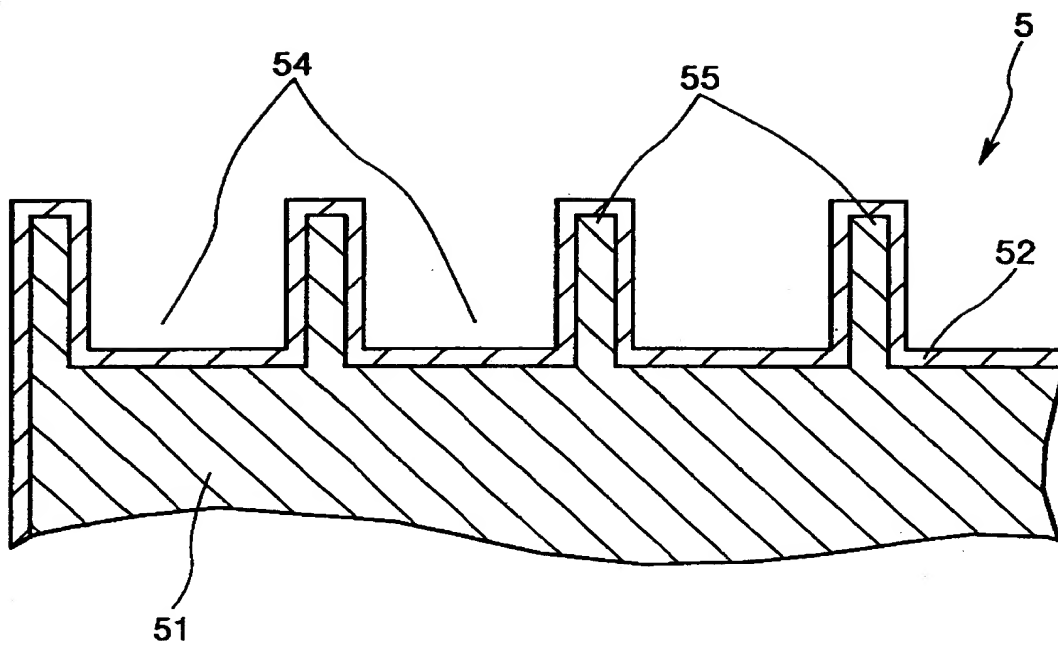
【図 7】



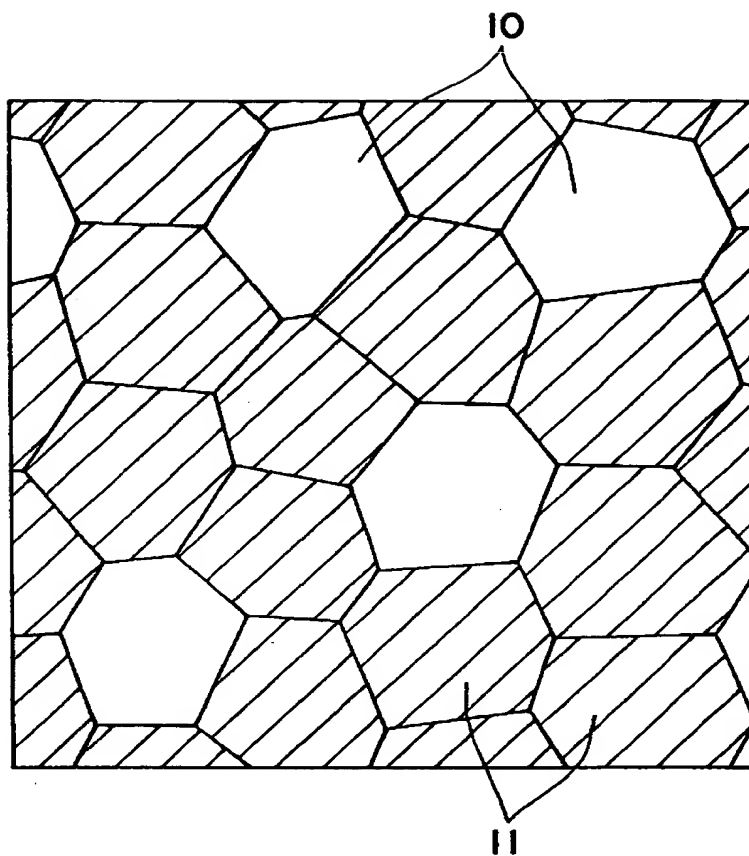
【図 8】



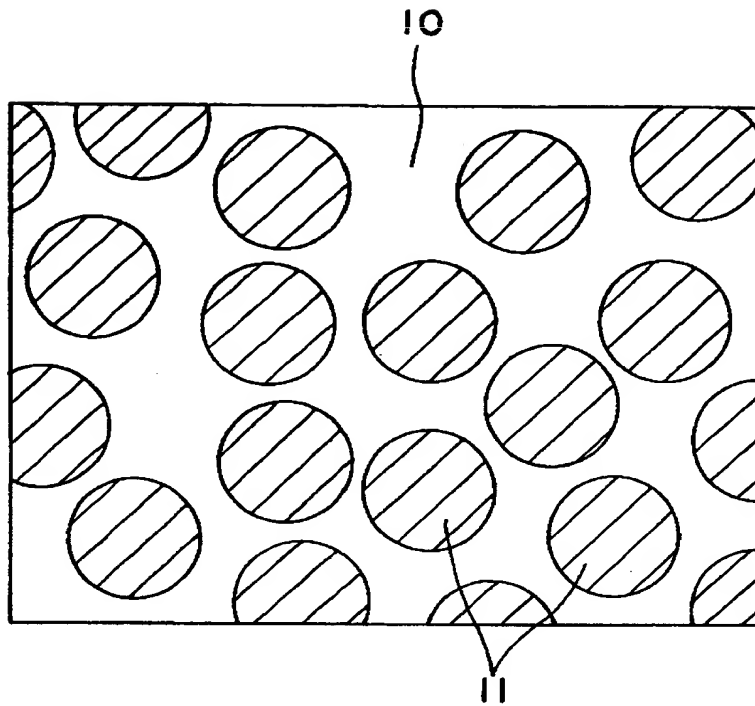
【図9】



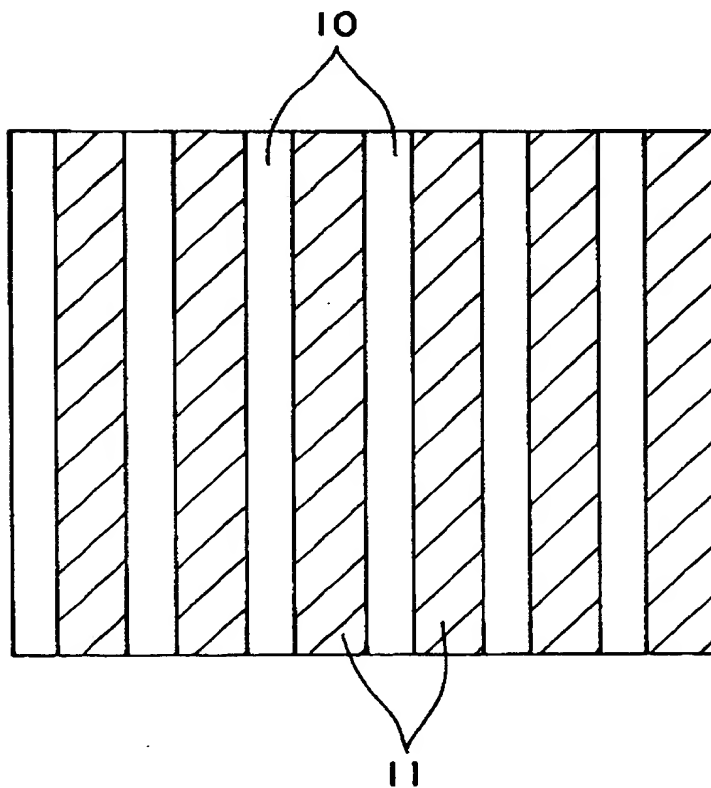
【図10】



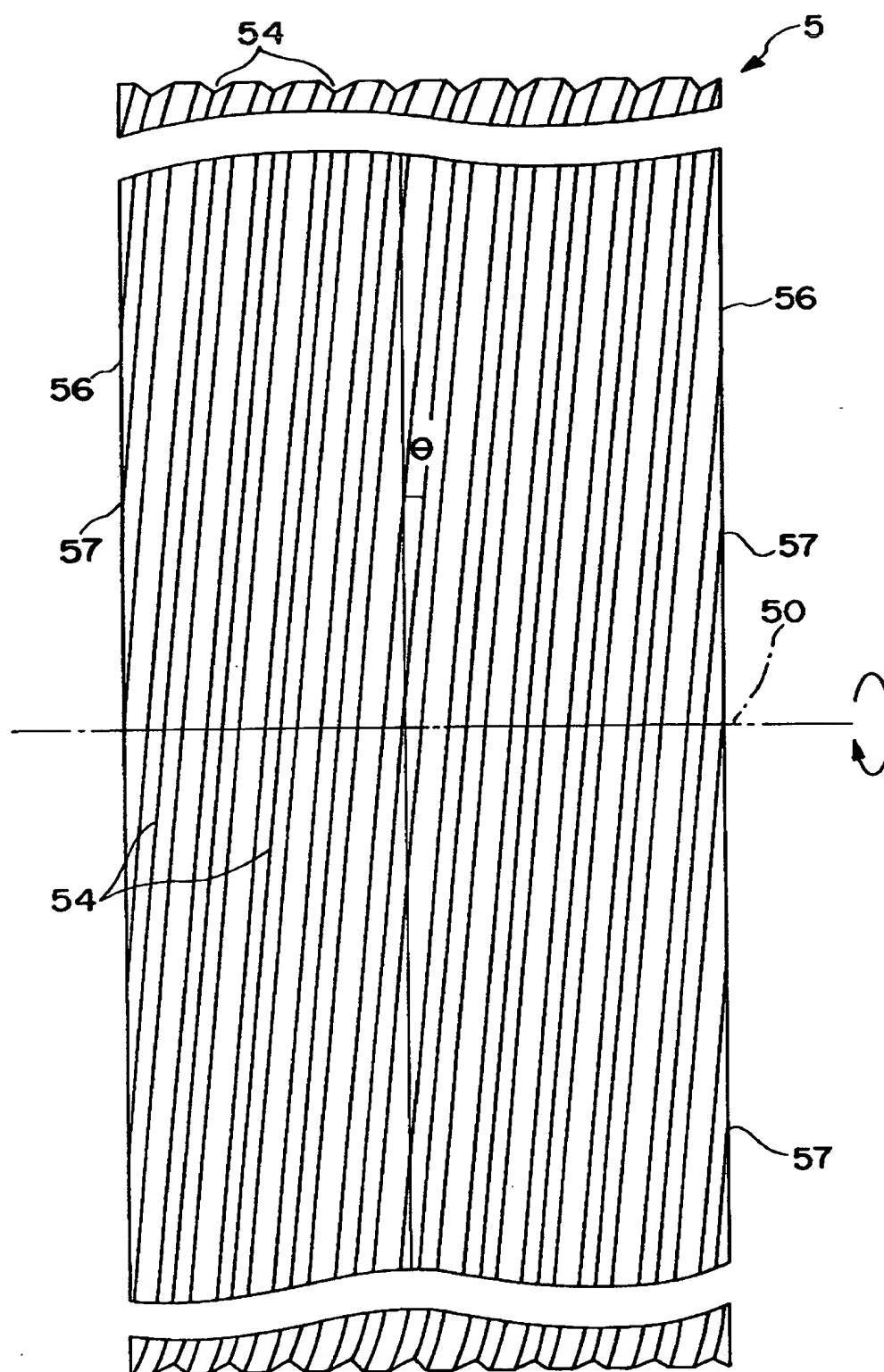
【図 11】



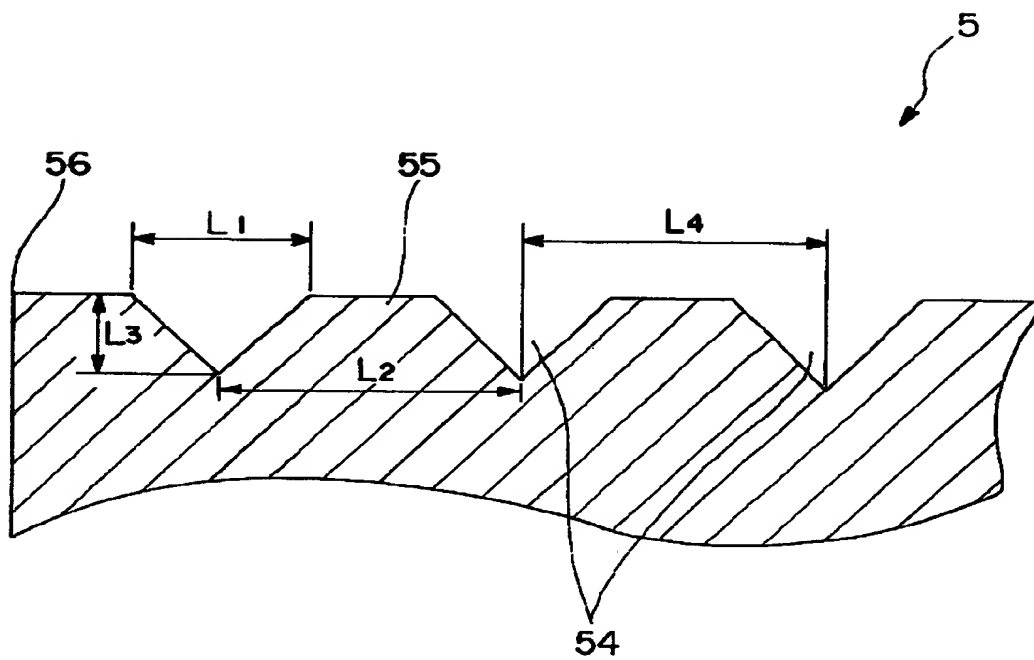
【図 12】



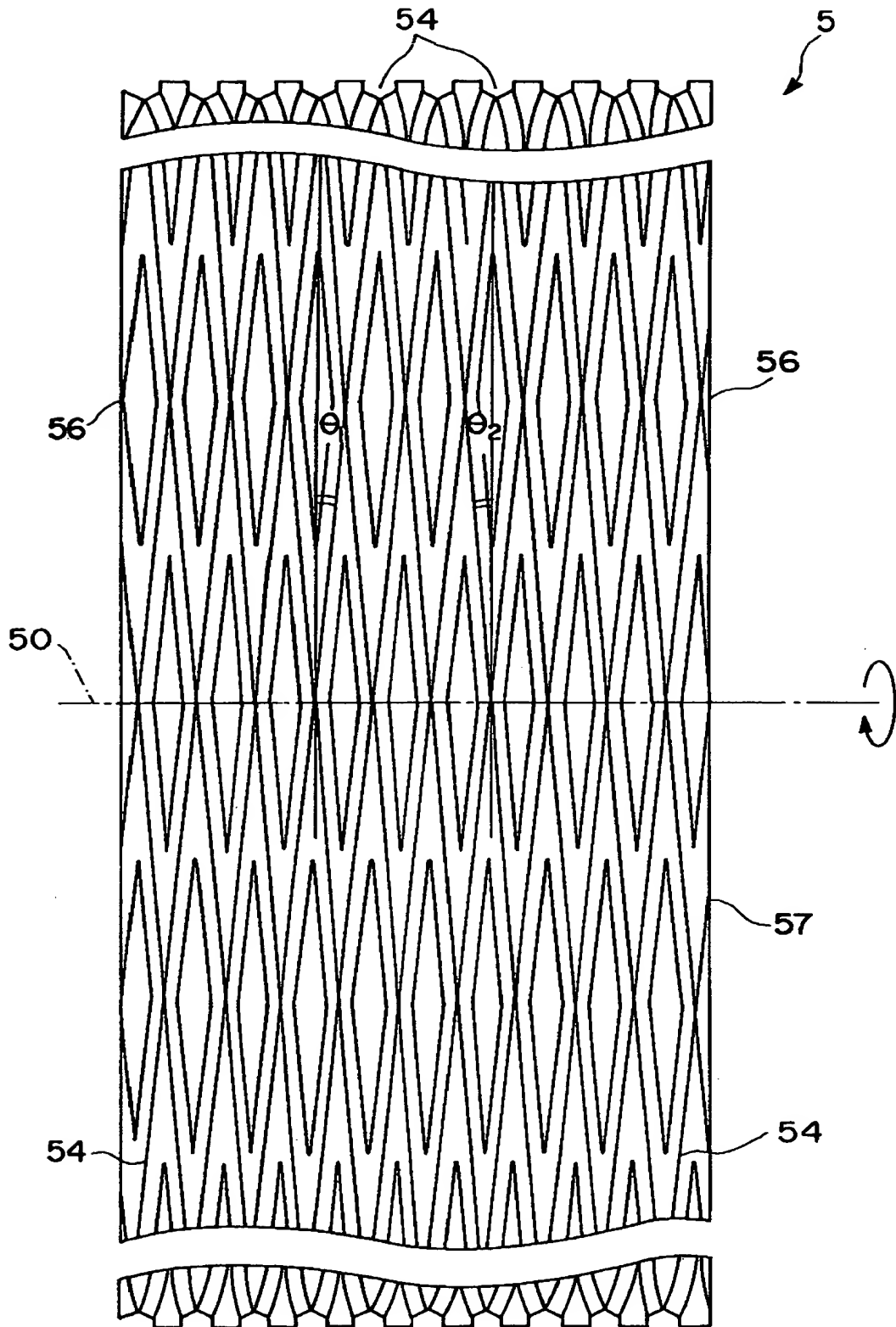
【図13】



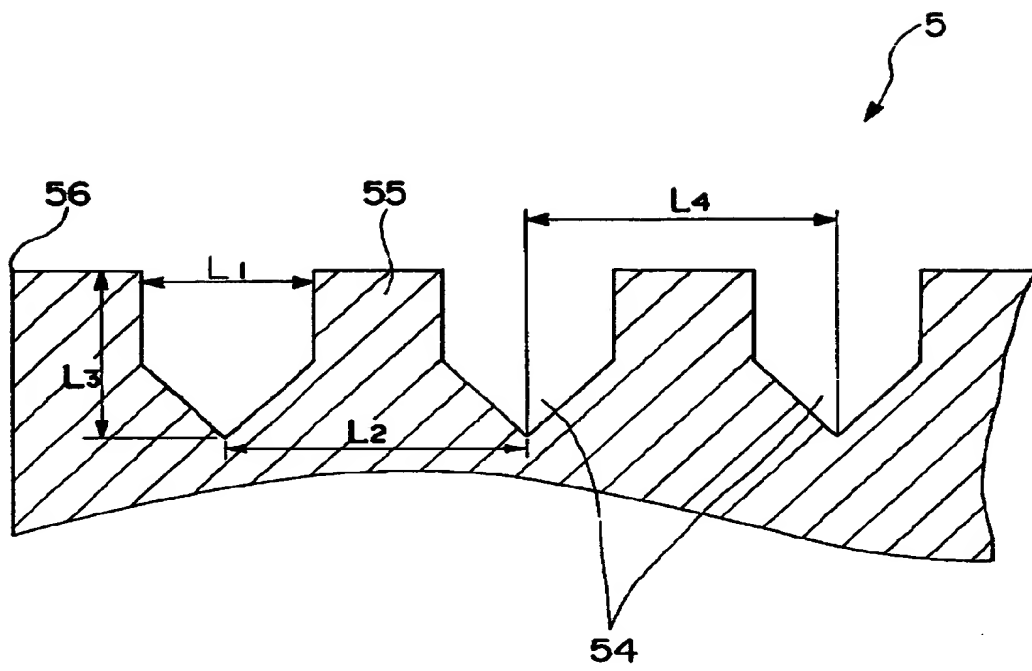
【図14】



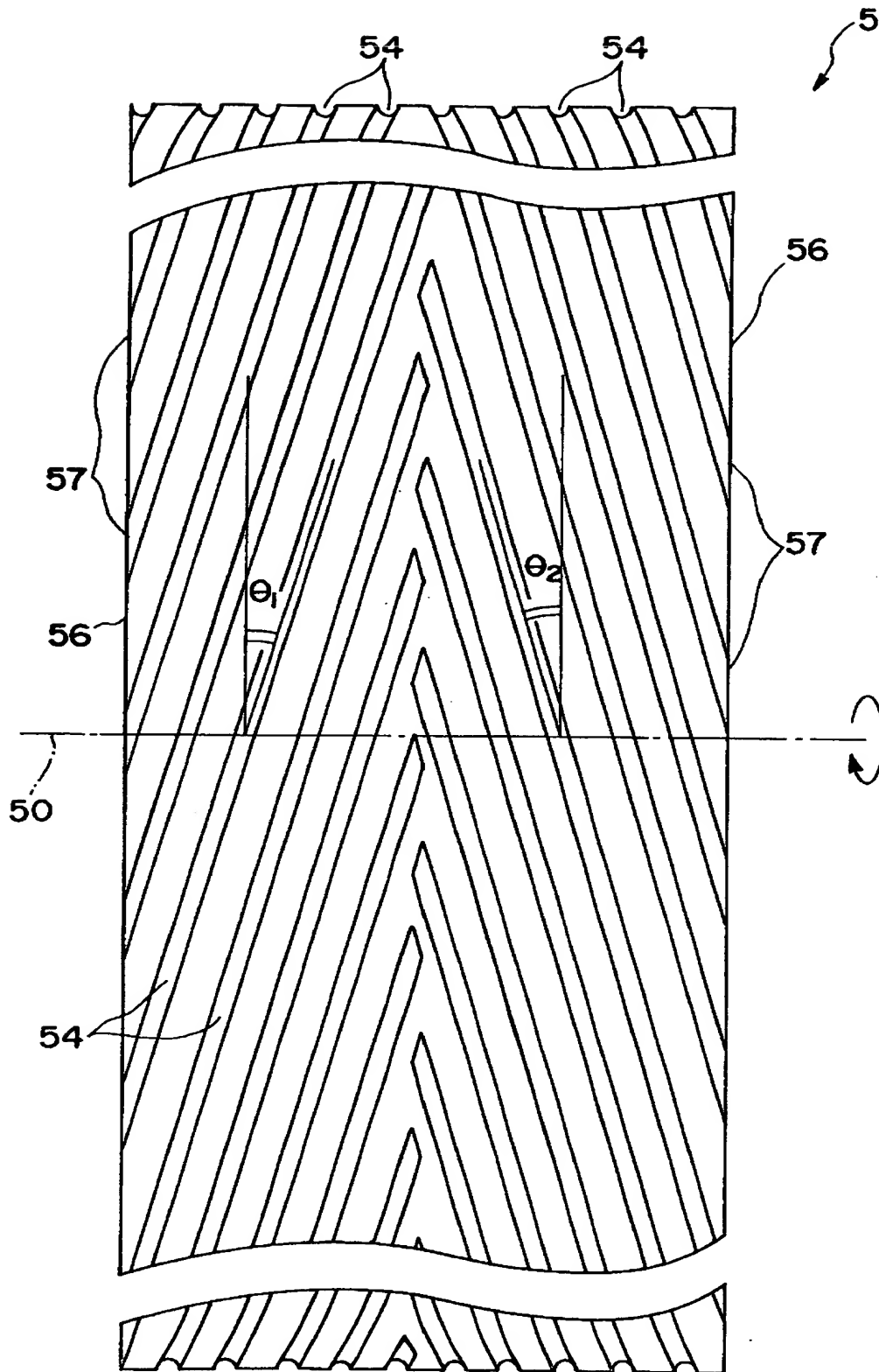
【図15】



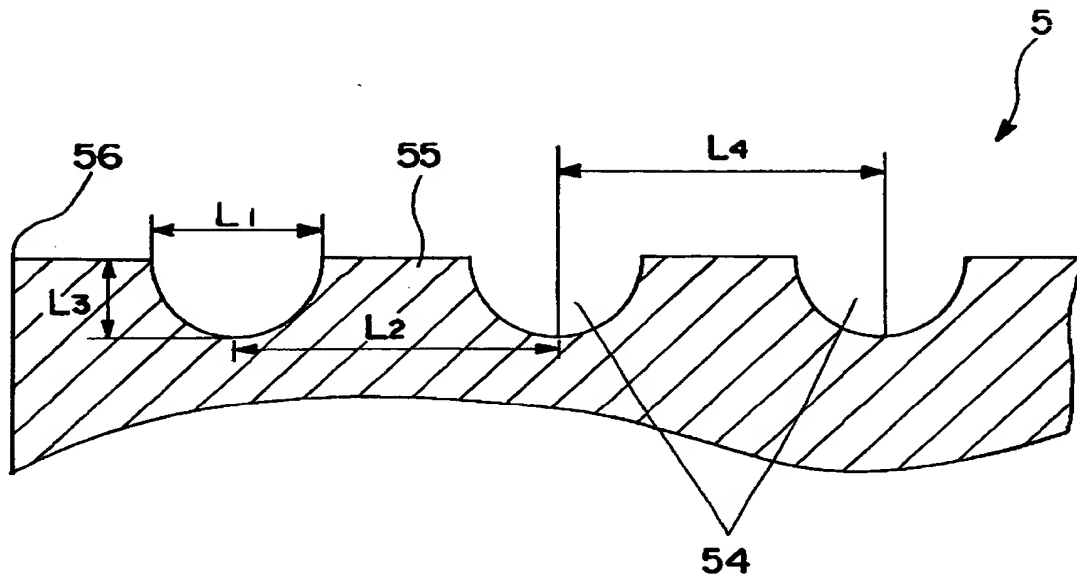
【図16】



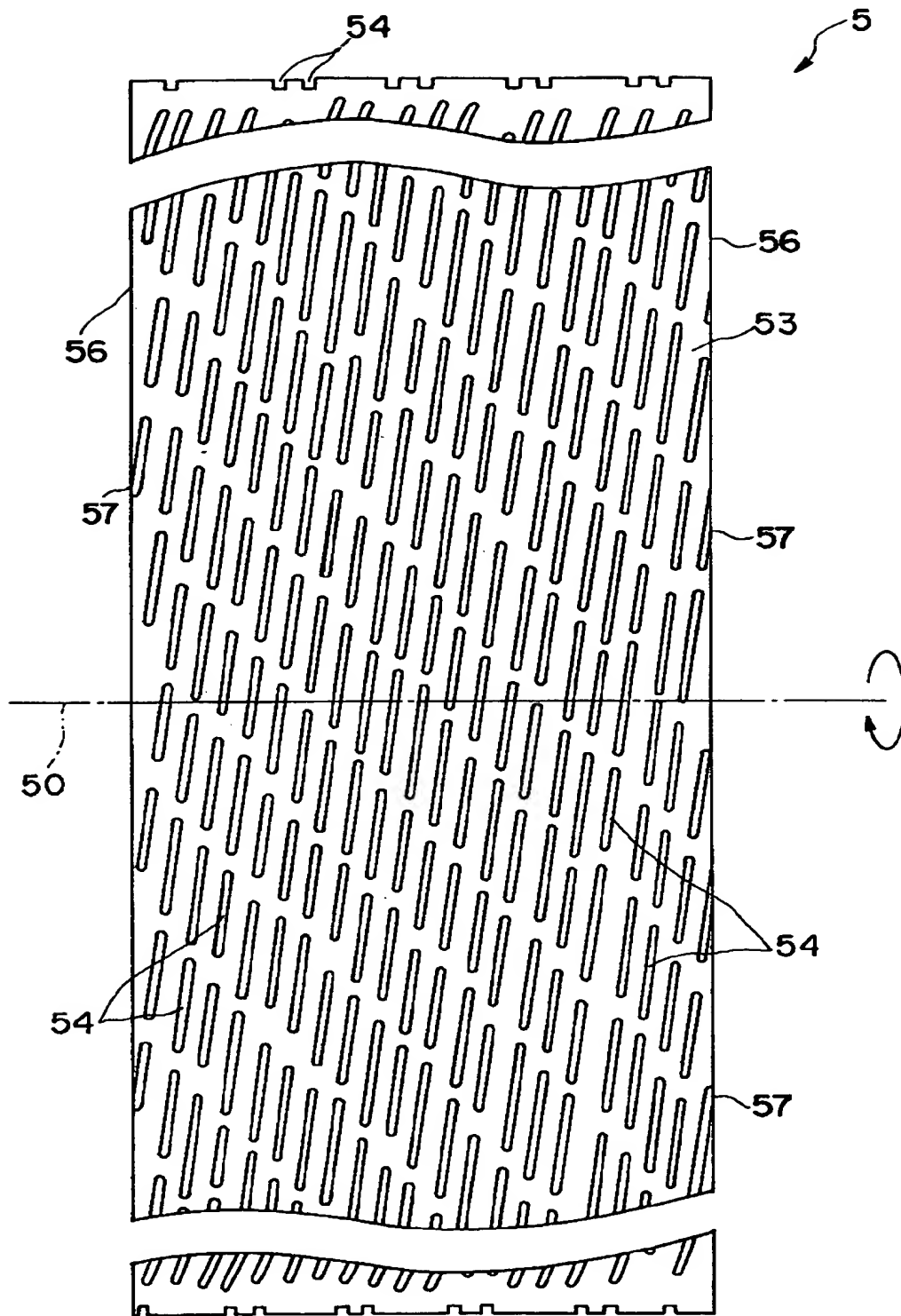
【図 17】



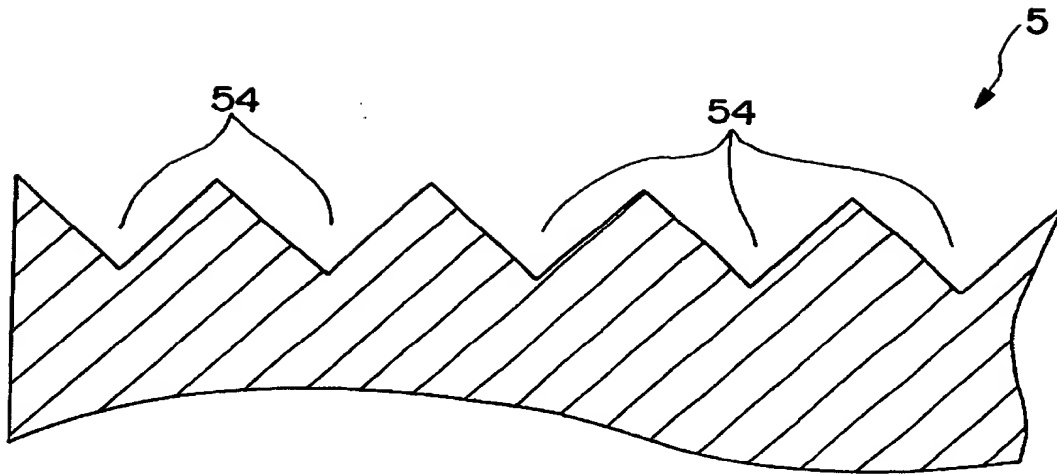
【図18】



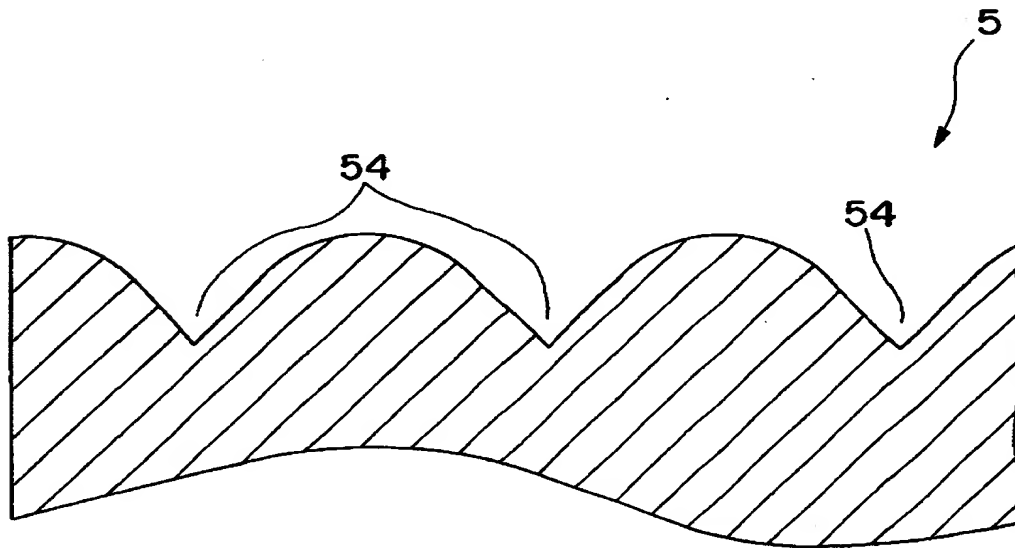
【図19】



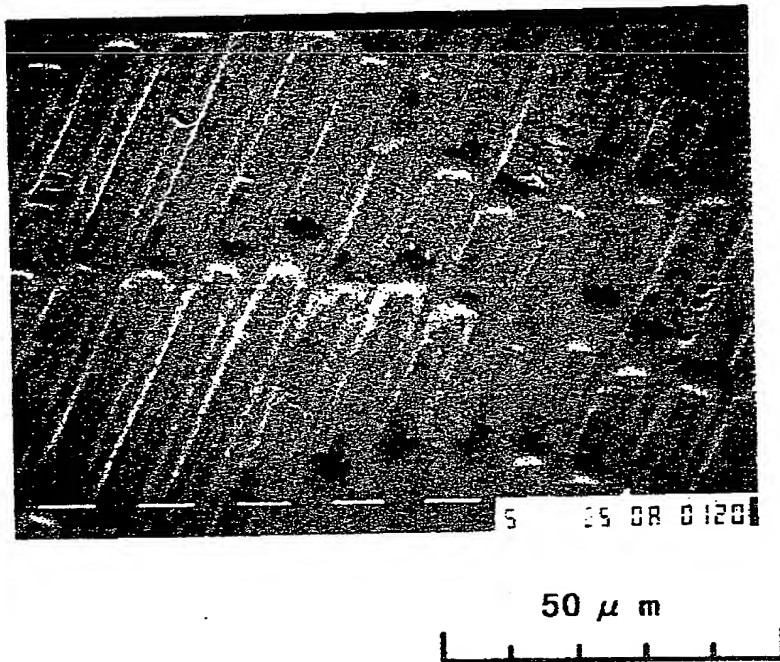
【図20】



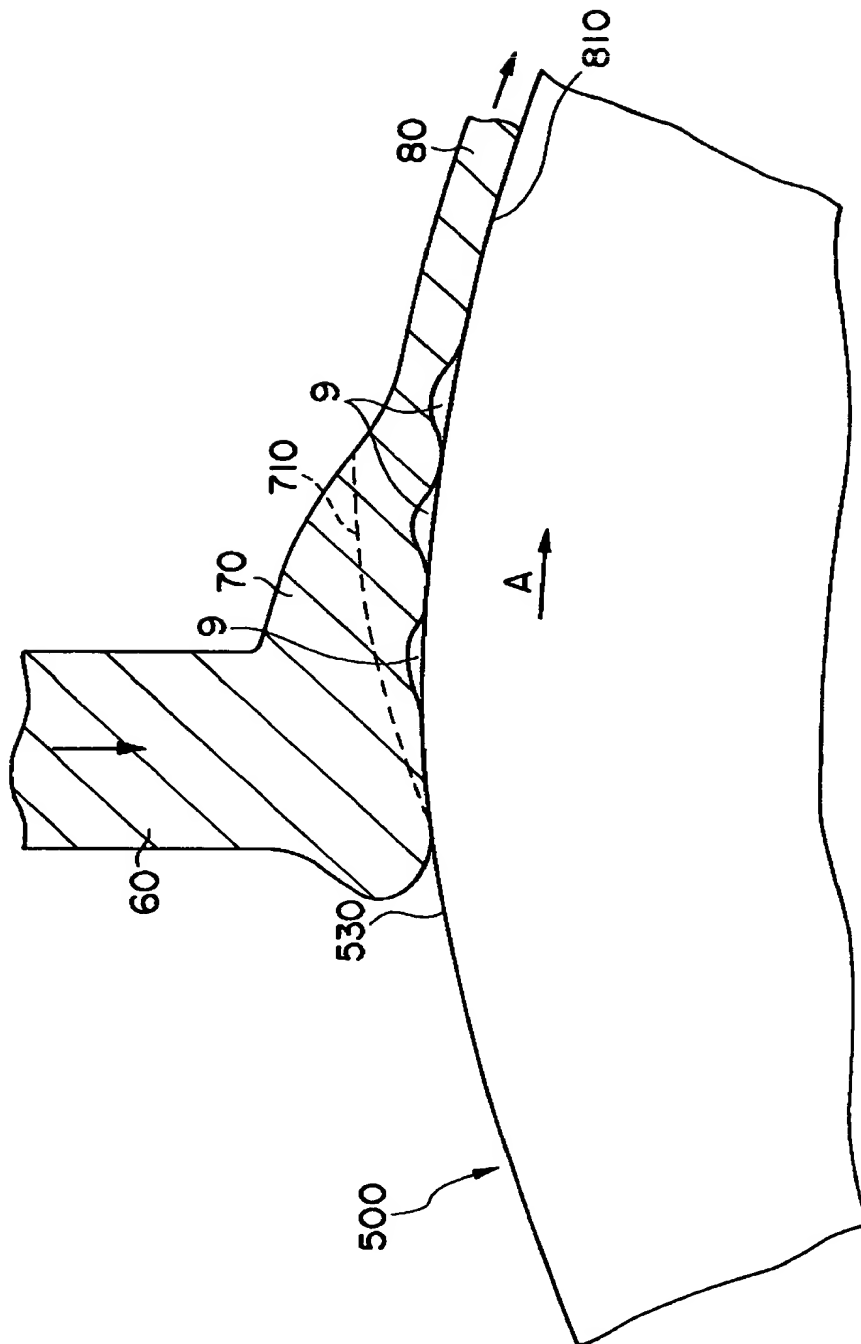
【図21】



【図 22】



【図 2 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気特性が優れ、信頼性に優れた磁石を提供することができる冷却ロール、薄帯状磁石材料、磁石粉末およびボンド磁石を提供すること。

【解決手段】 急冷薄帯製造装置 1 は、筒体 2 と、加熱用のコイル 4 と、冷却ロール 5 とを備えている。筒体 2 の下端には、磁石材料の溶湯 6 を射出するノズル 3 が形成されている。冷却ロール 5 の周面 5 3 には、ディンプル矯正手段が設けられている。急冷薄帯 8 は、ヘリウムガスのような不活性ガス（雰囲気ガス）中で、溶湯 6 をノズル 3 から射出し、冷却ロール 5 の周面 5 3 に衝突させ、冷却固化することにより製造される。このとき、冷却ロール 5 の周面 5 3 上に、ディンプル矯正手段が設けられていることにより、周面 5 3 との接触面において発生するディンプルは分割され、巨大ディンプルの発生が防止される。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名 セイコーエプソン株式会社